

日 本 国 特 許 庁
JAPAN PATENT OFFICE

20.07.2004

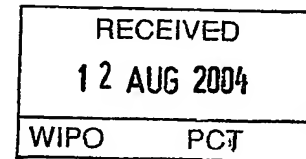
別紙添付の書類に記載されている事項は下記の出願書類に記載されている事項と同一であることを証明する。

This is to certify that the annexed is a true copy of the following application as filed with this Office.

出 願 年 月 日
Date of Application: 2004年 4月22日

出 願 番 号
Application Number: 特願2004-127312
[ST. 10/C]: [JP2004-127312]

出 願 人
Applicant(s): 積水化学工業株式会社

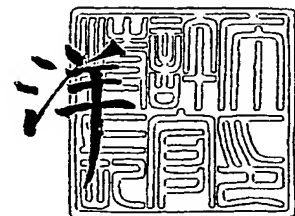


PRIORITY DOCUMENT
SUBMITTED OR TRANSMITTED IN
COMPLIANCE WITH
RULE 17.1(a) OR (b)

2004年 7月 9日

特許庁長官
Commissioner,
Japan Patent Office

小 川



【書類名】 特許願
【整理番号】 P04038
【提出日】 平成16年 4月22日
【あて先】 特許庁長官殿
【国際特許分類】 H01L 21/00
【発明者】
 【住所又は居所】 東京都八王子市北野町 5 9 3 - 8 積水化学工業株式会社内
 【氏名】 安西 純一郎
【発明者】
 【住所又は居所】 東京都八王子市北野町 5 9 3 - 8 積水化学工業株式会社内
 【氏名】 中野 良憲
【発明者】
 【住所又は居所】 東京都八王子市北野町 5 9 3 - 8 積水化学工業株式会社内
 【氏名】 川崎 真一
【発明者】
 【住所又は居所】 東京都八王子市北野町 5 9 3 - 8 積水化学工業株式会社内
 【氏名】 中武 純夫
【発明者】
 【住所又は居所】 東京都八王子市北野町 5 9 3 - 8 積水化学工業株式会社内
 【氏名】 真弓 聡
【発明者】
 【住所又は居所】 東京都八王子市北野町 5 9 3 - 8 積水化学工業株式会社内
 【氏名】 宮本 栄司
【発明者】
 【住所又は居所】 東京都八王子市北野町 5 9 3 - 8 積水化学工業株式会社内
 【氏名】 武内 稔公
【特許出願人】
 【識別番号】 000002174
 【氏名又は名称】 積水化学工業株式会社
【代理人】
 【識別番号】 100085556
 【弁理士】
 【氏名又は名称】 渡辺 昇
【選任した代理人】
 【識別番号】 100115211
 【弁理士】
 【氏名又は名称】 原田 三十義
【先の出願に基づく優先権主張】
 【出願番号】 特願2003-181395
 【出願日】 平成15年 6月25日
【先の出願に基づく優先権主張】
 【出願番号】 特願2003-351283
 【出願日】 平成15年10月 9日
【先の出願に基づく優先権主張】
 【出願番号】 特願2003-351284
 【出願日】 平成15年10月 9日
【手数料の表示】
 【予納台帳番号】 009586
 【納付金額】 16,000円

【提出物件の目録】

【物件名】

特許請求の範囲 1

【物件名】

明細書 1

【物件名】

図面 1

【物件名】

要約書 1

【書類名】 特許請求の範囲**【請求項 1】**

処理ガスを被処理物の表面に吹付け、該表面を処理する装置において、一方向に延びるスリットをその延び方向と交差する方向に等ピッチで複数並設してなるスリットアレイを有し、各スリットから処理ガスを吹出す処理部と、前記処理部を被処理物に対し、前記並設方向と交差する方向に相対移動させる移動機構とを備えたことを特徴とする表面処理装置。

【請求項 2】

前記相対移動方向が、各スリットの延び方向に沿っていることを特徴とする請求項 1 に記載の表面処理装置。

【請求項 3】

前記スリットの各々の延び方向と互いの並設方向とが直交し、前記相対移動方向が、前記延び方向に沿っていることを特徴とする請求項 1 に記載の表面処理装置。

【請求項 4】

前記スリットが、前記相対移動方向に対し斜めにそれぞれ延びていることを特徴とする請求項 1 に記載の表面処理装置。

【請求項 5】

前記スリットが、前記相対移動方向に対し斜めにそれぞれ延びるとともに、前記相対移動方向と直交する方向に互いに並設されていることを特徴とする請求項 1 に記載の表面処理装置。

【請求項 6】

前記スリットが、前記相対移動方向に対し斜めにそれぞれ延びるとともに、この延び方向と直交する方向に互いに並設されていることを特徴とする請求項 1 に記載の表面処理装置。

【請求項 7】

前記スリットのうち 1 のスリットの延び方向の一端部と、所定の整数個隣りのスリットの延び方向の他端部とが、前記相対移動方向に沿う同一直線上に位置していることを特徴とする請求項 4～6 の何れかに記載の表面処理装置。

【請求項 8】

前記ピッチが、前記スリットと被処理物との間の距離を有効範囲の上限近傍としたときの有効処理幅と略等しくなるように設定されていることを特徴とする請求項 1～7 の何れかに記載のプラズマ処理装置。

【請求項 9】

前記処理部を被処理物に対し前記相対移動方向と交差する方向に相対揺動させる揺動機構を更に備えたことを特徴とする請求項 1～9 の何れかに記載の表面処理装置。

【請求項 10】

前記処理部が、前記スリットアレイを前記延び方向に複数段有し、隣り合うスリットアレイのスリットどうしが、前記並設方向にずれていることを特徴とする請求項 1～9 の何れかに記載の表面処理装置。

【請求項 11】

前記ずれの大きさが、前記ピッチの n 分の 1 (n は、前記スリットアレイの数) であることを特徴とする請求項 10 に記載の表面処理装置。

【請求項 12】

前記処理部が、前記スリットアレイを前記延び方向に複数段有しており、隣り合うスリットアレイの一方に対応する第 1 揺動機構と、他方に対応する第 2 揺動機構を更に備え、これら第 1、第 2 揺動機構が、それぞれ対応スリットアレイを互いに同一方向、かつ被処理物に対し前記相対移動方向と交差する方向に相対揺動させ、しかも第 1 揺動機構の揺動位相と第 2 揺動機構の揺動位相が、互いにずれていることを特徴とする請求項 1～9 の何れかに記載の表面処理装置。

【請求項 13】

前記処理部が、等ピッチで並設された複数の電極板を有し、隣接する電極板どうしが、互いに逆の極性を付与されるとともに、これら隣接電極板どうし間にスリット状をなす処理ガスの通路が形成され、各処理ガス通路が、前記スリットとして提供され、ひいては、前記複数の電極板によって前記スリットアレイが構成されており、前記処理ガス通路にて処理ガスをプラズマ化して吹出し、被処理物をプラズマ処理することを特徴とする請求項 1～12 の何れかに記載の表面処理装置。

【請求項 14】

前記処理部が、前記並設方向に分離可能に連結された複数の電極モジュールを有し、各電極モジュールが、等ピッチで並設された複数の電極板を含み、前記スリットアレイの一部を構成していることを特徴とする請求項 13 に記載の表面処理装置。

【請求項 15】

隣り合う 2 つの電極モジュールにおいて、互いの対向端に配置された電極板どうしが、重ね合わされ、1 の合体電極板を構成し、この合体電極板が、前記隣り合う 2 つの電極モジュールの他の各電極板と等厚であることを特徴とする請求項 14 に記載の表面処理装置。

【請求項 16】

前記処理部が、処理ガスを均一化する整流路を有し、この整流路に複数のスリットが分岐するようにして連なっていることを特徴とする請求項 1～15 に記載のプラズマ処理装置。

【請求項 17】

前記処理部が、前記並設方向に分離可能に連結された複数のモジュールユニットを有し、各モジュールユニットが、前記電極モジュールと、この電極モジュールに接続された整流モジュールを備え、この整流モジュールが、処理ガスを均一化する整流路を有し、この整流路に同じモジュールユニットの電極モジュールのスリットが分岐するようにして連なっていることを特徴とする請求項 14 又は 15 に記載のプラズマ処理装置。

【請求項 18】

互いに等ピッチで並設された複数のスリットを有する処理部を、被処理物に対し前記並設方向と交差する方向に相対移動させながら、処理ガスを各スリットから吹出して被処理物の表面に吹付け、該表面の処理を行うことを特徴とする表面処理方法。

【請求項 19】

被処理物を、前記スリットの延び方向に沿って相対移動させながら、前記処理ガスの吹出しを行なうことを特徴とする請求項 18 に記載の表面処理方法。

【請求項 20】

被処理物を、前記スリットの延び方向に対し斜めに相対移動させながら、前記処理ガスの吹出しを行なうことを特徴とする請求項 18 に記載の表面処理方法。

【請求項 21】

前記ピッチを、前記スリットと被処理物との間の距離を有効範囲の上限近傍としたときの有効処理幅と略等しくなるように設定しておき、前記距離が前記有効範囲の上限近傍になるようにして処理を行なうことを特徴とする請求項 18～20 の何れかに記載のプラズマ処理方法。

【請求項 22】

前記処理部が、前記等ピッチをなすスリットからなるスリットアレイを前記延び方向に複数段配置することにより構成され、しかも隣り合う段のスリットアレイどうしが前記並設方向にずれており、

前記相対移動を、前記複数段のスリットアレイについて一体に行うことを特徴とする請求項 18～21 の何れかに記載の表面処理方法。

【請求項 23】

前記処理部を、被処理物に対し前記相対移動方向と交差する方向に更に相対揺動させながら、前記処理ガスの吹出しを行うことを特徴とする請求項 18～21 の何れかに記載の表面処理方法。

【請求項 24】

前記処理部が、前記等ピッチをなすスリットからなるスリットアレイを前記延び方向に複数段配置することにより構成されており、

前記相対移動と併行して、隣り合う段のスリットアレイどうしを、被処理物に対し前記相対移動方向と交差する方向に、位相を互いにずらして相対揺動させることを特徴とする請求項 18～21 の何れかに記載の表面処理方法。

【請求項 25】

前記揺動の振幅を、前記ピッチの 2 分の 1 又は 2 分の 1 強とすることを特徴とする請求項 23 又は 24 に記載の表面処理方法。

【請求項 26】

前記揺動の周期を、被処理物がスリットの長さ分の距離だけ相対移動する時間の整数分の 1 に設定することを特徴とする請求項 23～25 の何れかに記載の表面処理方法。

【書類名】明細書

【発明の名称】表面処理装置及び方法

【技術分野】

【0001】

この発明は、プラズマCVDを始めとするプラズマ処理や熱CVDなどの、処理ガスを被処理物に吹付けて成膜やエッチング等の表面処理を行なう装置及び方法に関する。特に、プラズマ処理においては、被処理物を電極間空間の外部に配置し、これに向けて電極間で形成したプラズマを吹出す所謂リモート式のプラズマ処理装置及び方法に関する。

【背景技術】

【0002】

例えば、特許文献1には、表面処理装置としてリモート式のプラズマ処理装置が記載されている。装置は、垂直をなす電極板を横に複数並設してなるプラズマ処理部を有している。これら電極板のうち1つ置き電極板が高周波電源に接続され、他の1つ置き電極板が接地されている。隣り合う電極板間に形成されたスリットには、上方から処理ガスが導入される。併行して、電源から上記1つ置き電極板への高周波給電によって、隣り合う電極板間のスリット内に高周波電界が印加される。これによって、処理ガスがプラズマ化される。このプラズマ化されたガスが、上記スリットの下端から吹出され、下方に配置された被処理物に当てられる。これにより、被処理物のプラズマ表面処理がなされるようになっている。

特許文献2には、電極板の延び方向ひいては隣り合う電極板間のスリットの延び方向と直交する方向に被処理物を移動させながらプラズマを吹付けることが記載されている。電極板ひいてはスリットを被処理物の全幅に渡る長さにより、被処理物の全体を一度に処理できる。

特許文献3に記載の装置では、電極板の対を左右に複数並設するとともに、被処理物を電極板間のスリットの延び方向に沿って相対移動させるようになっている。

【0003】

【特許文献1】特開平5-226258号公報（第1頁）

【特許文献2】特開2002-143795号公報（第1頁）

【特許文献3】特開2003-249492号公報（第1頁）

【発明の開示】

【発明が解決しようとする課題】

【0004】

上掲の特許文献1、2の装置では、被処理物が大面積になればなるほど、スリットひいては電極板を長大にしなければならなかった。そうすると、電極板が自重、クーロン力、熱応力等によって湾曲しやすくなってしまう。スリットや電極板の寸法精度の確保も容易でない。また、処理部全体の重量が電極板の枚数に応じて指数的に増大してしまう。特許文献3の装置では、電極板の対ひいてはそれらの間のスリットを等ピッチに配置する構成になっておらず、処理間隔が一定にならない。

【0005】

本発明は、上記事情に鑑みてなされたものであり、プラズマ表面処理をはじめ熱CVDなども含む成膜やエッチング等の表面処理において、処理ガスを吹出す各スリットを短小にしても、大面積の被処理物を効率良く表面処理でき、更に処理間隔を一定にできるようにすることを目的とする。

【課題を解決するための手段】

【0006】

上記目的を達成するために、本発明に係る表面処理装置は、処理ガスを被処理物（ワーク）の表面に吹付け、該表面を処理する装置において、一方向に延びるスリットをその延び方向と交差する方向に等ピッチで複数並設してなるスリットアレイを有し、各スリットから処理ガスを吹出す処理部と、前記処理部を被処理物に対し、前記並設方向と交差する方向に相対移動させる移動機構とを備えたことを特徴とする。

これによって、各スリットを短くでき、その一方、被処理物が大面積であっても、効率良く表面処理することができ、処理間隔を一定にすることもできる。

【0007】

前記相対移動方向が、各スリットの延び方向に沿っていてもよい。この場合、前記スリットの各々の延び方向（すなわち前記相対移動方向）と互いの並設方向とは、直交しているのが望ましいが、斜めに交差していてもよい。また、前記ピッチが、前記スリットと被処理物との間の距離すなわちワーキングディスタンスを有効範囲（許容範囲）の上限近傍としたときの有効処理幅と略等しくなるように設定されていることが望ましい。これによって、各スリットからのプラズマによって処理される領域を前記並設方向に連続させることができる。ここで、前記スリットと被処理物との間の距離の有効範囲とは、被処理物上の或る点における処理レートを有効な一定値以上に維持出来る範囲を言う（図4参照）。また、有効処理幅とは、1つのスリットから吹出されたプラズマによって表面処理がなされる範囲のうち、その処理が有効な範囲の幅寸法を言い、処理が有効な範囲とは、当該1つのスリットに対応する処理レートが、最大値の所定割合（例えば、15%～25%）以上となる範囲を言う。

【0008】

前記スリットが、前記相対移動方向に対し斜めにそれぞれ延びていてもよい。これによって、表面処理の均一性を向上できる。

この斜設構造において、前記スリットが、前記相対移動方向に対し斜めにそれぞれ延びるとともに、前記相対移動方向と直交する方向に互いに並設されていてもよく、或いは、前記スリットが、前記相対移動方向に対し斜めにそれぞれ延びるとともに、この延び方向と直交する方向に互いに並設されていてもよい。この斜設構造においても、前記ピッチが、前記スリットと被処理物との間の距離を有効範囲の上限近傍としたときの有効処理幅と略等しくなるように設定されていてもよい。

【0009】

上記斜設構造において、前記スリットのうち1のスリットの延び方向の一端部と、所定の整数個隣りのスリットの延び方向の他端部とが、前記相対移動方向に沿う同一直線上に位置していることが望ましい。これによって、表面処理の均一性を一層向上できる。

【0010】

前記処理部を被処理物に対し前記相対移動方向と交差する方向に相対揺動させる揺動機構を更に備えてもよい。これによって、表面処理の一層の均一化を図ることができる。前記揺動方向は、前記並び方向に沿っているか、前記延び方向と直交する方向に沿っているのが望ましい。

【0011】

前記処理部が、前記スリットアレイを前記延び方向に複数段有していてもよい。これによって、表面処理を十分に行うことができる。

隣り合う段のスリットアレイのスリットどうしは、前記並設方向にずれていることが望ましい。これによって、表面処理の均一化を図ることができる。特に、前記スリットの延び方向と前記相対移動方向が平行である場合に、縞状のムラが出来るのを有効に防止できる。

【0012】

前記ずれの大きさは、前記ピッチの n 分の1（ n は、前記スリットアレイの数）であることが望ましい。これによって、表面処理の均一性をより一層向上できる。

【0013】

前記複数段構成において、隣り合うスリットアレイの一方に対応する第1揺動機構と、他方に対応する第2揺動機構を更に備え、これら第1、第2揺動機構が、それぞれ対応スリットアレイを互いに同一方向、かつ被処理物に対し前記相対移動方向と交差する方向に相対揺動させ、しかも第1揺動機構の揺動位相と第2揺動機構の揺動位相が、互いにずれていてもよい。これによって、表面処理の均一性を一層向上させることができる。

【0014】

本発明の表面処理装置は、処理ガスをスリットアレイから吹出して被処理物に当てるものであり、プラズマ処理装置の他、熱CVD装置も含む。

プラズマ処理装置の場合には、前記処理部が、等ピッチで並設された複数の電極板を有し、隣接する電極板どうしが、互いに逆の極性を付与されるとともに、これら隣接電極板どうし間にスリット状をなす処理ガスの通路が形成され、各処理ガス通路が、前記スリットとして提供され、ひいては、前記複数の電極板によって前記スリットアレイが構成されており、前記処理ガス通路にて処理ガスをプラズマ化して吹出し、被処理物をプラズマ処理するようになっているのが望ましい。このように本発明をプラズマ処理装置に適用した場合には、電極板の小型化・軽量化を図ることができ、機械的強度を高めて湾曲しないようにすることができる。また、寸法精度の確保も容易になる。さらに、大面積の被処理物に対しては、電極板の並設数を増やすことにより対応でき、個々の電極板を大型化する必要がない。

【0015】

前記プラズマ処理装置において、前記処理部が、前記並設方向に分離可能に連結された複数の電極モジュールを有し、各電極モジュールが、等ピッチで並設された複数の電極板を含み、前記スリットアレイの一部を構成していてもよい。これによって、電極モジュールの連結数を調節することにより、スリットアレイ全体の大きさを被処理物の大きさに柔軟に対応させることができる。

【0016】

隣り合う2つの電極モジュールにおいて、互いの対向端に配置された電極板どうしが、重ね合わされ、1の合体電極板を構成し、この合体電極板が、前記隣り合う2つの電極モジュールの他の各電極板と等厚であることが望ましい。これによって、2つの電極モジュールの連結部分においてもスリットのピッチを他の部分と等しくすることができる。

【0017】

前記処理部が、処理ガスを均一化する整流路を有し、この整流路に複数のスリットが分岐するようにして連なっていることが望ましい。また、前記プラズマ処理装置において、前記処理部が、前記並設方向に分離可能に連結された複数のモジュールユニットを有し、各モジュールユニットが、前記電極モジュールと、この電極モジュールに接続された整流モジュールを備え、この整流モジュールが、処理ガスを均一化する整流路を有し、この整流路に同じモジュールユニットの電極モジュールのスリットが分岐するようにして連なっていることが望ましい。これによって、1つの整流路で均一化した処理ガスを複数のスリットに通すことができ、これら複数のスリットに対応する処理を一層均一に行なうことができる。

【0018】

本発明に係る表面処理方法は、互いに等ピッチで並設された複数のスリットを有する処理部を、被処理物に対し前記並設方向と交差する方向に相対移動させながら、処理ガスを各スリットから吹出して被処理物の表面に吹付け、該表面の処理を行うことを特徴とする。これによって、各スリットを短くでき、その一方、被処理物が大面積であっても、効率良く表面処理することができる。

【0019】

被処理物を、前記スリットの延び方向に沿って相対移動させながら、前記処理ガスの吹出しを行なってもよく、被処理物を、前記スリットの延び方向に対し斜めに相対移動させながら、前記処理ガスの吹出しを行なってもよい。

前記ピッチを、前記スリットと被処理物との間の距離を有効範囲の上限近傍としたときの有効処理幅と略等しくなるように設定しておき、前記距離が前記有効範囲の上限近傍になるようにして処理を行なうことが望ましい。

【0020】

前記処理部が、前記等ピッチをなすスリットからなるスリットアレイを前記延び方向に複数段配置することにより構成され、しかも隣り合う段のスリットアレイどうしが前記並設方向にずれており、前記相対移動を、前記複数段のスリットアレイについて一体に行う

ことが望ましい。これによって、表面処理の均一性を向上させることができる。

【0021】

前記処理部を、被処理物に対し前記相対移動方向と交差する方向に更に相対揺動させながら、前記処理ガスの吹出しを行うことにしてもよい。これによって、表面処理の一層の均一化を図ることができる。

【0022】

前記処理部が、前記等ピッチをなすスリットからなるスリットアレイを前記延び方向に複数段配置することにより構成されており、前記相対移動と併行して、隣り合う段のスリットアレイどうしを、被処理物に対し前記相対移動方向と交差する方向に、位相を互いにずらして相対揺動させることにしてもよい。

【0023】

前記揺動の振幅は、被処理物の相対移動の距離と比べると十分に小さいのが望ましい。また、前記揺動の振幅を、前記ピッチの2分の1又は2分の1強とすることが望ましい。これによって、表面処理の均一性を確実に確保することができる。

【0024】

前記揺動の周期を、被処理物がスリットの長さ分の距離だけ相対移動する時間の整数分の1に設定することが望ましい。これによって、表面処理の均一性を一層確実に確保することができる。

【0025】

本発明は、略常圧（大気圧近傍の圧力）の環境下でのプラズマ処理に対し、特に有効である。本発明における略常圧とは、 $1.013 \times 10^4 \sim 50.663 \times 10^4 \text{ Pa}$ の範囲を言い、圧力調整の容易化や装置構成の簡易化を考慮すると、 $1.333 \times 10^4 \sim 10.664 \times 10^4 \text{ Pa}$ が好ましく、 $9.331 \times 10^4 \sim 10.397 \times 10^4 \text{ Pa}$ がより好ましい。

【発明の効果】

【0026】

本発明によれば、各スリットを短くでき、その一方、被処理物が大面積であっても効率良く表面処理することができ、処理間隔を一定にすることもできる。

【発明を実施するための最良の形態】

【0027】

以下、本発明の実施形態を図面にしたがって説明する。

図1及び図2は、本発明の基本構造に係る第1実施形態を示したものである。表面処理装置としての常圧プラズマ処理装置Mは、プラズマ処理ヘッド1（処理部）と、処理ガス供給源2と、電源3と、移動機構4を備えている。プラズマ処理装置M1は、液晶用ガラス基板や半導体ウェハーなどの等の大面積のワークWを被処理物とし、その表面を略常圧下（大気圧近傍下）でプラズマ処理するものである。

【0028】

処理ガス供給源2は、1または複数の処理ガス成分を気相や液相で貯えるとともに、液相のものは気化させ、複数成分の場合は適量ずつ混合して、処理目的に応じた処理ガスを生成するようになっている。

【0029】

電界印加手段としての電源3は、処理ヘッド1でのプラズマ形成用の電圧として、例えばパルス電圧を出力するようになっている。このパルスの立上がり時間及び／又は立下り時間は、 $10 \mu\text{s}$ 以下、パルス継続時間は、 $200 \mu\text{s}$ 以下、後記電極間のスリット10aでの電界強度は $1 \sim 1000 \text{ kV/cm}$ 、周波数は 0.5 kHz 以上であることが望ましい。

なお、電源3は、パルス電圧に限らず、正弦波状の高周波交流電圧を出力するものであってもよく、直流電圧を出力するものであってもよい。

【0030】

移動機構4には、水平なワークセットテーブル5（図2にのみ図示）が接続されている

。このワークセットテーブル5の上にワークWが水平にセットされるようになっている。移動機構4は、ワーク台5ひいてはワークWを前後方向（図1の矢印方向）に搬送する。これによって、ワークWが処理ヘッド1の下方に通され、プラズマ表面処理されるようになっている。なお、ワークWは、往復移動の他、往方向または復方向に1回移動されるだけで処理が完了しワーク台5から取り出されるようになっていてもよい。勿論、ワークWが位置固定される一方、移動機構4が、処理ヘッド1に接続され、処理ヘッド1を移動させるようになっていてもよい。移動機構4としてローラコンベア等を用いてもよい。ローラコンベアの場合、その上にワークWを直接的にセットでき、したがって、ワークセットテーブル5が不要になる。

【0031】

図2に示すように、装置Mのワークセットテーブル5には、ヒータ等のワーク温調装置5H（被処理物温調手段）が付設されている。このワーク温調装置5HによってワークWを処理に適した温度になるように加熱または冷却するようになっている。ワーク温調装置5Hは、ワークセットテーブル5の外部に配置されていてもよい。

【0032】

プラズマ処理装置Mの処理ヘッド1について説明する。

図2に示すように、処理ヘッド1は、ワークセットテーブル5ひいてはその上にセットされたワークWより上側に位置するようにして、図示しない架台にて支持されている。処理ヘッド1は、1つのモジュールユニット1Xにて構成されている。モジュールユニット1Xは、電極モジュール10と、この電極モジュール10の上側に設置された整流モジュール20を有している。電極モジュール10は、プラズマ放電部を構成し、整流モジュール20は、整流部を構成している。

【0033】

整流モジュール20には、受容れポート21と整流路が形成されている。受容れポート21に、前記処理ガス供給源2からの管2aが接続されている。整流路は、整流チャンバー20aやスリット状（ないしスポット状）の整流孔23a等にて構成されている。ガス整流モジュール20の下端部に整流孔形成部材として整流板23が設けられている。この整流板23に、複数の整流孔23aが左右に等ピッチで形成されている。各整流孔23aは、前後方向（図2の紙面と直交する方向）に延びるスリット状をなしているが、これに代えて、前後に分散配置された多数のスポット状の孔にしてもよい。整流孔23aは、後記電極板間のスリット10aと一対一に対応するようにして連なっている。すなわち、1つの整流路に複数のスリット10aが分岐するようにして連なっている。なお、整流板23を上下に複数設け、これにより整流チャンバーを複数に仕切るようにしてもよい。供給源2の処理ガスは、管2aを経

ガス整流モジュール20の受容れポート21に受容れられ、チャンバー20aや整流孔23a等からなる整流路により整流・均一化された後、電極モジュール10へ導入されるようになっている。

【0034】

図1および図2に示すように、処理ヘッド1の電極モジュール10は、絶縁性のケーシング19と、このケーシング19内に收容された電極アレイ（電極列）とを有している。ケーシング19は、上下に開放されるとともに、ワークWの移動方向と直交する左右方向に延びる平面視長方形形状をなしている。ケーシング19の左右方向の長さは、ワークWの左右方向の幅寸法より大きい。

【0035】

ケーシング19内に收容された電極アレイは、複数（図では12個）の第1、第2電極板11、12にて構成されている。これら電極板11、12は、互いに同一形状、同一寸法の導電金属製の四角い平板で構成される。この電極板11、12が、それぞれ前後方向に沿う垂直をなし、互いに左右に等ピッチで並設されている。各電極板11、12の前後両端部が、ケーシング19の前後の長壁にそれぞれ固定され支持されている。

【0036】

上記電極板の極性は、並設方向に沿って互い違いになっている。すなわち、図1に示すように、電源3からの給電線3aが複数に分岐して、処理ヘッド1の1つ置き電極板11にそれぞれ接続されている。これら電極板11は、電界印加電極（ホット電極）となっている。処理ヘッド1の他の1つ置き電極板12は、接地線3bを介して接地され、接地電極（アース電極）となっている。電源3からのパルス電圧によって、隣り合う電極板11, 12どうし間にパルス電界が形成されるようになっている。

なお、詳細な図示は省略するが、各電極板11, 12の表面には、アルミナなどの固体誘電体層が溶射にて被膜されている。

【0037】

隣り合う電極板11, 12どうしの間には、垂直をなして前後方向（ワークWの移動方向）に延びるスリット10aが形成されている。複数の電極間スリット10aの左右方向の幅は、互いに等しい。各電極スリット10aの上端部は、上記整流モジュール20のスリット状整流孔23aのうち対応するものにそれぞれ連なっている。整流孔23aは、電極間スリット10aへの処理ガスの導入路となっている。電極間スリット10aは、処理ガスを通す通路となるとともに、上記電源3から電極板11への給電により電界が印加されてグロー放電の起きる放電空間となり、これにより、処理ガスがプラズマ化されるプラズマ化空間となっている。

【0038】

各電極スリット10aの下端部は、それぞれ開放され、前後方向に延びる処理ガス吹出し口となっている。

なお、ケーシング19の下端部に、吹出し口形成部材として底板を別途設けて電極板11, 12の下端面に宛がうとともに、この底板に各電極間スリット10aとストレートに連なるスリット状の吹出し口を形成することにしてもよい。この場合、電極間スリット10a及びそれに連なるスリット状吹出し口によって、特許請求の範囲の「スリット」が構成される。底板は、セラミックなどの絶縁材料で構成するとよい。

【0039】

処理ヘッド1において、左右に並設されたスリット10aによって、スリットアレイ100が構成されている。スリットアレイ100は、ワークWの左右幅より長く延在されている。

【0040】

ここで、処理ヘッド1のスリット10aの下端部（吹出し口）と、ワークWとの間の距離、すなわちワーキングディスタンスWD（図2）は、有効範囲内の上限近傍の値WD₀（以下、設定ワーキングディスタンスWD₀という。）に設定されている。図4に示すように、ワーキングディスタンスWDの有効範囲とは、ワークW上の或る地点で測定した処理レートが有効な一定の値以上に維持されている範囲を言う。ワーキングディスタンスが、この有効範囲を超えると、上記測定点での処理レートが、急激に低下する。すなわち、上記設定ワーキングディスタンスWD₀は、この急激な低下が起きる直前のワーキングディスタンスである。ここでは、例えば、WD₀ = 6 mmである。

【0041】

図3に示すように、電極板11, 12のピッチPは、上記設定ワーキングディスタンスWD₀における、各スリット10aからのプラズマ化された処理ガス（以下、適宜「プラズマガス」という。）による有効処理幅と略等大になるように設定されている。有効処理幅とは、1つのスリット10aから吹出されたプラズマガスによって表面処理がなされる範囲Sのうち、その処理が有効な範囲S₀の幅寸法を言う。有効処理範囲S₀とは、当該1つのスリット10aからのプラズマガスによる処理レートをRとし、その最大値をR_{max}とすると、この最大値R_{max}に対し、処理レートRが所定の割合α以上となる範囲を言う。すなわち、 $R \geq \alpha \times R_{max}$ を満たす範囲を言う。例えば、α = 15% ~ 25%である。なお、 $R = R_{max}$ となる地点は、通常、スリット10aの中心の直下である。処理範囲S及び有効処理範囲S₀は、上記 $R = R_{max}$ となる地点を中心にして左右に広がっている。

【0042】

処理範囲Sひいては有効処理範囲S₀の幅は、ワーキングディスタンスに依存する。ワーキングディスタンスが有効範囲内すなわち $WD \leq WD_0$ を満たす範囲内では、ワーキングディスタンスが大きくなればなるほど、有効処理範囲S₀の幅すなわち有効処理幅が広がる。したがって、本実施形態の装置Mにおいては、ワーキングディスタンスWを上限近傍値WD₀とすることにより、有効処理幅を可能な限り大きくし、この有効処理幅に電極ピッチPを合わせることで、電極ピッチPを可能な限り大きく設定している。

【0043】

上記構成の常圧プラズマ処理装置Mの動作を説明する。

処理ガス供給源2からの処理ガスは、処理ヘッド1のガス整流モジュール20で整流された後、各電極間スリット10aに均一に導入される。これと併行して、電源3からのパルス電圧が、電極モジュール10の1つ置き電極板11に印加される。これによって、各電極間スリット10aにパルス電界が形成されてグロー放電が起き、処理ガスがプラズマ化(励起・活性化)される。このプラズマ化された処理ガスが、下方へ均一に吹出される。同時に、移動機構4によってワークWが処理ヘッド1の下方を前後方向すなわちスリット10aと平行方向に通される。このワークWに各スリット10aからの処理ガスが吹き付けられる。これによって、成膜、エッチング、洗浄等の表面処理を行うことができる。

【0044】

1つの整流路で均一化した処理ガスを複数のスリット10aに導くことができ、これらスリット10a内における処理ガス流を互いに均等にすることができ、ひいては、これらスリット10aに対応する処理を互いに均等に行なうことができる。

図3に示すように、スリット10aのピッチPと有効処理幅との上記関係により、1つのスリット10aからのプラズマガスによって有効に表面処理される範囲と、その隣のスリット10aからのプラズマガスによって有効に表面処理される範囲とを連続させることができる。また、各電極板11、12の真下においては、図3の破線に示すように、両側のスリット10aからのプラズマガスによる処理レートが重なり合うことになる。したがって、同図の実線に示すように、実際の処理レートを倍増させることができる。これによって、ワークWを左右方向に万遍なく処理することができる。しかも、スリットアレイ100がワークWの左右幅より長く延在されているので、ワークWの左右全幅を一度に処理することができる。そして、移動機構4にてワークWを前後に移動させることにより、ワークWの全面を効率よく処理することができる。

【0045】

大面積(左右幅広)のワークに対しては、電極板11、12ひいては電極間スリット10aの並設数を増やすことにより対応できる。各電極板11、12の寸法は、ワークWの大きさに拘わらず短小にすることができる。したがって、寸法精度の確保が容易になるだけでなく、軽量化を図ることができ、自重、クーロン力、熱応力等による電極板11、12の撓み量を小さくできる。なお、左右両端以外の電極板11、12には、両側から逆方向のクーロン力が作用し、全体としてクーロン力が相殺されるため、湾曲を一層確実に防止することができる。

【0046】

更に、常圧プラズマ処理装置Mにおいては、ワーキングディスタンスをなるべく大きくとり、有効処理幅ひいてはピッチPを大きくとっているため、電極板11、12を十分に厚肉にすることができる。これによって、電極板11、12の強度を高めることができ、撓みを一層確実に防止することができる。

【0047】

次に、本発明の他の実施形態を説明する。以下の実施形態において既述の実施形態と同様の構成に関しては、図面に同一符号を付して説明を簡略化する。

【0048】

図5～図13は、本発明の具体構造に係る第2実施形態を示したものである。はじめに

、図5にしたがって、第2実施形態の概略を説明する。

第2実施形態に係る常圧プラズマ処理装置の処理ヘッド1は、モジュールユニット1Xを多数(複数)備えている。これらモジュールユニット1Xは、前側(図5において上側)と後側(図5において下側)に2段をなし、各段において左右に複数個並べられ、前後左右に当接するものどうしが、互いに分離可能に連結されている。各モジュールユニット1Xは、第1実施形態と同様に、電極モジュール10と、その上側に設置された整流モジュール20(図7参照)とで構成されている。したがって、処理ヘッド1において、複数の電極モジュール10は、前側と後側に2段をなして左右に並べられ、前後左右に当接するものどうしが、互いに分離可能に連結されている。隣り合う2つの電極モジュール10、10のうち一方を、「第1電極モジュール」とすると、他方が、「第2電極モジュール」となる。同様に、処理ヘッド1において、複数の整流モジュール20は、前側と後側に2段をなして左右に並べられている。処理ヘッド1を構成する全てのモジュールユニット1Xの整流モジュール20(図7参照)によって「整流部」が構成され、全ての電極モジュール10によって「プラズマ放電部」が構成されている。

【0049】

図5に示すように、各電極モジュール10は、所定数の電極板11、12を左右に一定ピッチPで並べることによって構成されている。(なお、図5では、簡略化のために、各電極モジュール10の電極板数を図6～図11の具体構造図より少なく図示してある。)

前側の段の全ての電極モジュール10の電極板11、12によって、前段の電極アレイが構成され、ひいては前段のスリットアレイ100が構成されている。後側の段の全ての電極モジュール10の電極板11、12によって、後段の電極アレイが構成され、ひいては後段のスリットアレイ100が構成されている。すなわち、処理ヘッド1には、スリットアレイ100が、前後2段設けられている。また、各電極モジュール10は、スリットアレイ100の一部を構成している。

【0050】

前後の各段において左右に隣り合う2つの電極モジュール10における、互いの対向端の電極板12、12(後述の通り、これら電極板を符号12R、12Lで表記する。)どうしは、重なり合い、1つの合体電極板12Xを構成している。合体電極板12Xは、他の電極板11、12と等厚になっている。これによって、前後各々のスリットアレイ100のスリットピッチが、2つの電極モジュールの連結部分においても他の部分と等しくなり、スリットアレイ100全体にわたって等ピッチPになっている。

【0051】

次に、第2実施形態の詳細構造を、図6～図13にしたがって説明する。

図7に示すように、各モジュールユニット1Xの整流モジュール20は、前後方向(図7の左右方向)に細長く伸びるハウジング29と、このハウジング29内に設けられた2枚(複数)の整流板23U、23Lを有している。ハウジング29の上面には、前後一對の受容れポート21が設けられている。処理ガス供給源2からの供給管2aが、各ユニット20ごとに分岐し、各受容れポート21に接続されている。

【0052】

図7および図8に示すように、ハウジング29内の2つの整流板23U、23Lは、上下に離間配置されている。これら整流板23U、23Lによって、ハウジング29の内部が、上下3段(複数段)のチャンバー20a、20b、20cに仕切られている。上段のチャンバー20aに、受容れポート21が連なっている。

【0053】

図13に示すように、整流板23U、23Lは、それぞれ多孔板にて構成されている。これら整流板23U、23Lの孔23c、23dを介して上下のチャンバー20a、20b、20cどうしが連通されている。各整流板23U、23Lの孔23c、23dは、例えば10mm～12mm間隔で格子点状に整列配置されている。ただし、上段の整流板23Uにおける受容れポート21の真下位置には、孔が設けられていない。これら孔23c、23dは、下側の整流板のものほど小孔になっている。例えば、上段の整流板23Uの

孔 23 c の直径は、3 mm であり、下段の整流板 23 L の孔 23 d の直径は、2 mm である。

各整流モジュール 20 のチャンバー 20 a, 20 b, 20 c 及び孔 23 c, 23 d によって、「整流路」が構成されている。

【0054】

図 8 に示すように、ハウジング 29 の底板 24 の上面には、4 つ（複数）の支柱 26 が設けられている。支柱 26 は、ハウジング 29 の全長にわたって前後（図 8 の紙面と直交する方向）に細長く延び、互いに左右に離れて配置されている。これら支柱 26 によって下段の整流板 23 L が支持されている。また、隣り合う支柱 26 どうしの間に下段のチャンバー 20 c が形成されている。すなわち、下段チャンバーが、支柱（隔壁）26 によって 5 つ（複数）に分割されている。各分割チャンバー 20 c は、前後に細長く延びている。このチャンバー 20 c が、底板 24 のガス導入孔 24 a を介して電極モジュール 10 の電極間スリット 10 a の上端部に連なっている。1 つのチャンバー 20 c は、隣り合う 2 つの電極間スリット 10 a と対応している。すなわち、各整流モジュール 20 の整流路に複数のスリット 10 a が分岐するようにして連なっている。

【0055】

処理ガス供給源 2 からの処理ガスは、供給管 2 a および整流モジュール 20 の前後一対の受容れポート 21 を経て、上段チャンバー 20 a に導入される。そして、整流板 23 U の多数の孔 23 c から中段のチャンバー 20 b に流れ込む。ここで、各受容れポート 21 の直下には孔 23 c が設けられていないため、処理ガスを上段チャンバー 20 a 内の全体に十分に拡散させたうえで、中段チャンバー 20 b に送ることができる。その後、処理ガスは、整流板 23 L の多数の孔 23 d から下段の各分割チャンバー 20 c に流れ込む。そこからハウジング底板 24 の導入孔 24 a を経て、電極モジュール 10 の各電極間スリット 10 a へ導かれる。

【0056】

図 6 に示すように、第 2 実施形態の各電極モジュール 10 は、左右に一定ピッチ P で並べられた複数（例えば 11 枚）の電極板 11, 12 と、これら電極板 11, 12 の前後両端に設けられた端壁 15（支持部）とを有し、前後に細長く延びている。

【0057】

図 6 および図 7 に示すように、前後両端の壁 15 は、それぞれ内壁部材 16 と、この内壁部材 16 の外側面にボルト締めされた外壁部材 17 とを有している。内壁部材 16 の外側面には、後述する冷媒溜め用の大きな凹部 16 f（図 12）が形成されている。外壁部材 17 は、この凹部 16 f を塞ぐ蓋の役目を担っている。外壁部材 17 は、ステンレス等の金属にて構成されているのに対し、内壁部材 16 は、樹脂にて構成されている。これは、後記金属ボルト 51 から金属製外壁部材 17 に放電が飛ばないようにするためである。内壁部材 16 の内側面には、後記外側壁以外の電極板数に対応する数の樹脂製の詰めブロック 14 が設けられている。詰めブロック 14 は、縦長状をなすとともに、互いに前後に隙間無く並べられている。

【0058】

図 6～図 8 に示すように、電極モジュール 10 の各電極板 11, 12 は、例えばアルミニウムやステンレス等の導電金属にて構成され、長さ方向を前後に向け、厚さ方向を左右に向け、幅方向を垂直に向けて配置されている。図 6、図 8 に示すように、ホット電極を構成する第 1 電極板 11 と、アース電極を構成する第 2 電極板 12 は、左右に交互に並べられている。左右両端には、それぞれアース電極である第 2 電極板 12 が配置されている。この左右両端の電極板 12 によって、電極モジュール 10 の左右の外側壁が構成されている。左端の電極板 12 を他と区別するときは、符号 12 に「L」を添えて表記し、右端の電極板 12 を他と区別するときは、符号 12 に「R」を添えて表記し、左右両端以外の第 2 電極板 12 を他と区別するときは、符号 12 に「M」を添えて表記する。

【0059】

左右に隣り合う 2 つの電極モジュール 10, 10 のうち左側のものを「第 1 電極モジュ

ール」とし、右側のものを「第2電極モジュール」とすると、左側の電極モジュール10における右端電極板12Rが、「第1端電極部材」となり、右側の電極モジュール10における左端電極板12Lが、「第2端電極部材」となる。逆に、右側の電極モジュール10を「第1電極モジュール」とし、左側の電極モジュールを「第2電極モジュール」とすると、右側の電極モジュール10における左端電極板12Lが、「第1端電極部材」となり、左側の電極モジュール10における右端電極板12Rが、「第2端電極部材」となる。

【0060】

電極モジュール10における両端以外の9枚の電極板11, 12Mは、互いに等厚の平板状をなしている。これら電極板11, 12Mの前後方向の長さは、例えば3000mmであり、左右方向の厚さは、例えば9mmであり、上下方向の幅は、例えば60mmである。図6に示すように、各電極板11, 12Mの前後の端面には、詰めブロック14が、それぞれ宛てがわれ、金属ボルト51にて固定されている。

【0061】

電極モジュール10の外側壁を兼ねた両端の電極板12L, 12Rは、内側の電極板11, 12Mより前後に長く延出し、左右両端の詰めブロック14と内壁部材16の左右端面に宛がわれるとともに、外壁部材17に突き当てられ、ボルト締めされている。

【0062】

図6～図9に示すように、電極板11, 12Mの両側面には、アルミナ(Al_2O_3)等からなる固体誘電体の板13が、それぞれ宛てがわれている。左端の電極板12Lの平坦な右側面と、右端の電極板12Rの平坦な左側面にも、同様の固体誘電体板13が、それぞれ宛てがわれている。これら固体誘電体板13の厚さは、例えば1mmである。なお、板13を宛がうのに代えて、固体誘電体の溶射等で被膜することにしてもよい。

【0063】

図6、図8、図9に示すように、隣り合う電極板11, 12どうしの間（正確にはそれらの固体誘電体板13どうしの間）には、狭い隙間すなわち電極間スリット10aが形成されている。1つの電極モジュール10全体では、10個の電極間スリット10aが形成されている。これら電極間スリット10aのピッチPは、上記電極板11, 12のピッチと等しい。

【0064】

図6、図9、図10に示すように、各電極間スリット10aを挟んで対向する2枚の固体誘電体板13の前側の端部どうし間、及び後側の端部どうし間には、スペーサ18が介在されている。これによって、各固体誘電体板13が電極板11, 12に押し当てられるとともに、電極間スリット10aの左右方向の厚さが所定に維持されている。電極間スリット10aの厚さは、例えば1mmである。

上述したように、各電極間スリット10aの上端部は、整流モジュール20の導入孔24aに連なっている（図8）。

【0065】

図8、図11(a)に示すように、各電極モジュール10の左端の電極板12Lの上側部と下側部は、他の電極板11, 12Mより薄肉となり、上下一対の第1薄肉部12g, 12gを構成している。左端電極板12Lの上下方向の中央部は、隣の電極モジュール10に向けて突出する凸状をなし、上記第1薄肉部12gより厚肉の第1厚肉部12fを構成している。図6に示すように、これら薄肉部12g及び厚肉部12fは、左端電極板12Lの全長にわたって前後に延びている。第1厚肉部12fの厚さは、例えば7mmであり、第1薄肉部12gの厚さは、例えば2mmである。

【0066】

一方、図8、図11(a)に示すように、各電極モジュール10の右端の電極板12Rの上下方向の中央部には、外側面に凹部が形成されている。これにより、右端電極板12Rの上下方向の中央部は、第2薄肉部12hを構成し、上側部と下側部は、薄肉部12hより厚肉の第2厚肉部12kを構成している。図6に示すように、これら薄肉部12h及

び厚肉部12kは、右端電極板12Rの全長にわたって前後に延びている。右端電極板12Rの第2薄肉部12hの厚さは、例えば2mmであり、第2厚肉部12kの厚さは、例えば7mmである。

【0067】

図11(b)、図12に示すように、プラズマ処理ヘッド1の前後の各段において左右に隣接する2つの電極モジュール10、10のうち、左側のモジュール10の凹状をなす第2薄肉部12hに、右側のモジュール10の凸状をなす第1厚肉部12fが嵌め込まれている。また、左側のモジュール10の凸状をなす第2厚肉部12kが、右側のモジュール10の凹状をなす第1薄肉部12gに嵌め込まれている。このようにして、左側のモジュール10の右端電極板12Rと右側のモジュール10の左端電極板12Lとが重ね合わされ、これら電極板12R、12Lによって、真平らな1つの合体電極板12Xが構成されている。合体電極板12Xは、アース電極を構成している。

【0068】

合体電極板12Xの厚さは、他の電極板11、12Mと同じ(9mm)である。これによって、図11(b)に示すように、電極板ピッチが、左右に隣接する2つの電極モジュール10の連結部分においてもそれ以外の部分と等しい大きさP(例えば $P=12\text{mm}$)になっている。すなわち、左側のモジュール10の電極板11、12Mと、合体電極板12Xと、右側のモジュール10の電極板11、12Mが、互いに等ピッチをなしている。これによって、スリットアレイ100の全体にわたって、スリット10aのピッチが、一定の大きさPに揃えられている。この結果、左右の電極モジュール10の連結部分で処理が不均一になるのを防止できる。

【0069】

図5、図9に示すように、第2実施形態の前段のモジュールユニット1Xと後段のモジュールユニット1Xどうしは、上記ピッチPの半分だけ左右にずれている。よって、前段の電極モジュール10と後段の電極モジュール10は、左右に半ピッチ($P/2$)だけずれている。これによって、前段のスリットアレイ100と後段のスリットアレイ100は、左右に半ピッチ($P/2$)だけずれている。

【0070】

この半ピッチのずれによって、図14の二点鎖線に示すように、前段のスリットアレイ100からの処理ガスによる処理の谷間の部分に、同図の破線に示すように、後段のスリットアレイ100からの処理ガスによる処理の山の部分を重ね、前側の山の部分に後側の谷に部分を重ねることができる。この結果、同図の実線に示すように、処理レートを左右方向に均すことができ、処理ムラを抑えることができる。

【0071】

図8に示すように、電極モジュール10の下端部には、底板10Lが設けられている。底板10Lは、セラミック等の絶縁材料からなり、電極板11、12Mの下面に宛がわれている。底板10Lには、吹出しスリット10bが複数形成されている。これら吹出しスリット10bは、各々前後に延びるとともに、互いに左右に等ピッチPで並設されている。上記電極間スリット10aと同様に、吹出しスリット10bのピッチは、左右に隣接する2つの電極モジュール10の連結部分でも他の部分と等しい。

【0072】

各吹出しスリット10bの下側部には段差が形成され、そこより上側が幅広になっており、そこに、電極間スリット10aを挟んで対向する2枚の固体誘電体板13、13の下端部が挿入されている。これら2枚の固体誘電体板13、13の間の電極間スリット10aが、吹出しスリット10bの段差より下側部に連なっている。吹出しスリット10bの下端部は、底板10Lの下面に開口し、処理ガスの吹出し口になっている。電極間スリット10aとそれに連なる吹出しスリット10bの下端部によって、特許請求の範囲の「スリット」が構成されている。

【0073】

第2実施形態のモジュールユニット1Xにおける電極板11、12の給電構造について

説明する。

図7および図8に示すように、整流モジュール20の前側部には、それを垂直に貫通する給電ピン31が、左右に並んで5本(複数)設けられている。これら給電ピン31の上端部は、ホット線(給電線)3aを介して電源3に接続され、下端部は、第1電極板11にそれぞれ埋め込まれている。同様にして、整流モジュール20の後側部には、接地ピン32が設けられ、その上端部がアース線(接地線)3bを介して接地され、下端部が第2電極板12にそれぞれ埋め込まれている。

【0074】

第2実施形態の電極モジュール10には、電極板11、12の冷却手段(温調手段)が設けられている。

詳述すると、図7および図8に示すように、各電極板11、12Mの内部には、温調路として上下に離れて3つ(複数)の冷媒路10c、10d、10eが形成されている。各冷媒路10c~10eは、電極板11、12Mの全長にわたって前後に延びている。

【0075】

図7に示すように、電極板11、12Mの前後両端面に宛てがわれた詰めブロック14には、上下に離れて3つの通路14a、14b、14cが形成されている。図9に示すように、各通路14a~14cは、前後に延びる路部分14eと、これと左右に交差する路部分14fとを有し、平面視T字状をなしている。上段の通路14aの路部分14eが、対応電極板11、12Mの上段の冷媒路10cに連なり、中段の通路14bの路部分14eが、中段の冷媒路10dに連なり、下段の通路14cの路部分14eが、下段の冷媒路10eに連なっている。

【0076】

なお、図10に示すように、電極板11、12Mの各冷媒路10c~10eと詰めブロック14の通路14eとの連結部分には、円筒状のコネクタブッシュ65が設けられている。コネクタブッシュ65の外周面と前後両端面との角は、面取りされ、そこにリング66が設けられている。このリング66は、ボルト51(図7)をねじ込むことによって圧潰されるようになっている。

【0077】

図9に示すように、左右に並べられた詰めブロック14における同一高さの通路14a~14cの左右方向の路部分14fどうしは、互いに左右一直線に連なっている。

【0078】

図8および図9に示すように、各電極モジュール10の左端電極板12Lの厚肉部12fには、冷媒路12bが形成されている。冷媒路12bは、左端電極板12Lのほぼ全長にわたって前後に延びている。この冷媒路12bの前後両端の近傍部分に、左端詰めブロック14の中段通路14bの左右路部分14fが連なっている。

【0079】

図9および図12に示すように、各電極モジュール10において、冷媒路12bの前後両端部は、それぞれ前後の内壁部材16の左側部の通路16bを介して冷媒溜め16fに連なっている。

【0080】

同様に、右端電極板12Rの上側の厚肉部12kには、冷媒路12aが形成され、下側の厚肉部12kには、冷媒路12cが形成されている。これら冷媒路12a、12cは、右端電極板12Rのほぼ全長にわたって前後に延びている。上段の冷媒路12aの前後両端の近傍には、右端詰めブロック14の上段通路14aの左右路部分14f(図7)が連なり、下段の冷媒路12cの前後両端の近傍には、下段通路14cの左右路部分14f(図7)が連なっている。各冷媒路12a、12cの前後両端部は、それぞれ前後の内壁部材16の右側部の通路16a、16cを介して冷媒溜め16fに連なっている。

【0081】

図7に示すように、電極モジュール10の前側の内壁部材16の上面には、冷媒溜め16fに連なる冷媒インレットポート61が設けられている。冷媒供給源6から延びる冷媒

供給管 6 a が、冷媒インレットポート 6 1 に連なっている。

一方、電極モジュール 1 0 の後側の内壁部材 1 6 の上面には、冷媒溜め 1 6 f に連なる冷媒アウトレットポート 6 2 が設けられている。このポート 6 2 から冷媒排出管 6 b が延びている。

【0082】

供給源 6 からの冷水等の冷媒は、管 6 a を経て、インレットポート 6 1 から前側内壁部材 1 6 の冷媒溜め 1 6 f に一旦溜められた後、3つの通路 1 6 a ~ 1 6 c に分流される。右側の上段通路 1 6 a を経た冷媒は、右端電極板 1 2 R の上段冷媒路 1 2 a に入り、一部がそのまま後方へ流れるとともに、残りが、前側のブロック上段通路 1 4 a に流れ込み、そこから各電極板 1 1, 1 2 M の上段冷媒路 1 0 c に分流し、後方へ流れる。また、左側の中段通路 1 6 b を経た冷媒は、左端電極板 1 2 L の冷媒路 1 2 b に入り、一部がそのまま後方へ流れるとともに、残りが、前側のブロック中段通路 1 4 b に流れ込み、そこから各電極板 1 1, 1 2 M の中段冷媒路 1 0 d に分流し、後方へ流れる。さらに、右側の下段通路 1 6 c を経た冷媒は、右端電極板 1 2 R の下段冷媒路 1 2 c に入り、一部がそのまま後方へ流れるとともに、残りが、前側のブロック下段通路 1 4 c に流れ込み、そこから各電極板 1 1, 1 2 M の下段冷媒路 1 0 e に分流し、後方へ流れる。これによって、電極板 1 1, 1 2 を全体的に冷却（温度調節）できるようになっている。

【0083】

各電極板 1 1, 1 2 M の冷媒路 1 0 c ~ 1 0 e の後端部に達した冷媒は、それぞれ後側のブロック通路 1 4 a ~ 1 4 c を経て、電極板 1 2 L, 1 2 R の冷媒路 1 2 a ~ 1 2 c の後端部に合流する。そして、後側の内壁通路 1 6 a ~ 1 6 c を経て、後側冷媒溜め 1 6 f に溜められる。その後、アウトレットポート 6 2 から管 6 b を経て排出される。

【0084】

ワーキングディスタンス及び有効処理幅を可及的に大きくとり、ひいてはピッチ P を大きくすることにより、電極板 1 1, 1 2 を可及的に厚肉にすることができる。これにより、冷媒路 1 0 a ~ 1 0 c を容易に形成できる。

左右両端の端電極板 1 2 L, 1 2 R は、厚肉部 1 2 f, 1 2 k を有しているので、この厚肉部 1 2 f, 1 2 k に冷媒路 1 2 a ~ 1 2 c を開穿することができ、冷媒路の確保が容易である。

【0085】

第2実施形態において、左右幅の大きなワーク W を処理する場合には、モジュールユニット 1 X を継ぎ足すことにより、スリットアレイ 1 0 0 を簡単に長くすることができる。勿論、左右幅の小さなワーク W の場合には、一部のモジュールユニット 1 X を抜き取ることにより、スリットアレイ 1 0 0 を簡単に短くすることができる。これによって、ワーク W の大きさに柔軟に対応することができる。

左右に隣合う2つの電極モジュール 1 0, 1 0 どうしにおいて、一方の凸状をなす厚肉部 1 2 f (1 2 k) を他方の凹状をなす薄肉部 1 2 h (1 2 g) に嵌め込むことにより、両者の対向端電極板 1 2 R, 1 2 L どうしをしっかりと連結、合体化できる。分離の操作も容易である。

【0086】

図 1 5 は、第2実施形態の変形態様を示したものである。

図 1 5 (b) に示すように、この変形態様では、左右に隣り合う2つの電極モジュール 1 0 で作る合体電極板 1 2 X が、上下に4つの部分電極板 1 2 p (すなわち複数の板状をなす部分電極部材) に分割されている。各部分電極板 1 2 p は、他の電極板 1 1, 1 2 M と同じ左右方向の厚さを有するとともに、図 1 5 の紙面と直交する前後方向に延びる角柱形状をなしている。図 1 5 (a) に示すように、これら部分電極板 1 2 p のうち上から1段目と3段目のものが、左側の電極モジュール 1 0 の右端部に取り付けられ、左側の電極モジュール 1 0 の右端電極板 1 2 R を構成し、2段目と4段目のものが、右側の電極モジュール 1 0 の左端部に取り付けられ、右側の電極モジュール 1 0 の左端電極板 1 2 L を構成している。詳細な図示は省略するが、各部分電極板 1 2 p の長手方向の両端部は、対応

電極モジュール10の端壁15（図6参照）にそれぞれ連結され、支持されている。

【0087】

左側の電極モジュール10に取り付けられた1段目と3段目の部分電極板12p, 12pと、右側の電極モジュール10に取り付けられた2段目と4段目の部分電極板12p, 12pとが、互いに噛み合わされ、これにより、1つの合体電極板12Xが構成されている。

【0088】

図15の変形態様によれば、端電極板12L, 12Rに凹凸を形成する必要が無く、製造が極めて容易であり、平面精度の確保も容易である。これにより、固体誘電体板13に確実に面接触させることができる。しかも、端電極板12L, 12Rを構成する部分電極板12pが、他の電極板11, 12Mと同じ厚さであり、上記第2実施形態の厚肉部12f, 12kより厚くなっており、かつ、薄肉部12g, 12hが無い。したがって、剛性を十分に確保でき、撓みを抑えることができる。これによって、各端電極板12L, 12Rと、それに宛がわれるべき固体誘電体板13との間に隙間が形成されるのを確実に防止できる。この結果、安定したプラズマを得ることができる。更には、スリットアレイ100を、左右の電極モジュール10の連結部分においても確実に所定ピッチPに維持することができ、表面処理の均一性をより向上できる。

また、端電極板12L, 12Rを構成する部分電極板12pの製造が容易で加工工数が少なく、しかも、すべての部分電極板12pを互いに同一形状にすることができる。これによって、部材コストを安価にすることができる。

【0089】

なお、各部分電極板12pには、冷媒路10f（温調路）が形成されている。詳細な図示は省略するが、これら冷媒路10fは、端壁15の冷媒溜め16f（図9参照）にそれぞれ連なっている。また、端電極板12L, 12R以外の電極板11, 12Mの冷媒路10c, 10d, 10eは、冷媒路10fを介さずに冷媒溜め16fに連なっている。

【0090】

図16は、本発明の第3実施形態を示したものである。第3実施形態は、本発明の基本構造に係る第1実施形態（図1及び図2）の変形態様である。

第3実施形態では、上記第1実施形態と同様に、処理ヘッド1のケーシング19が左右に延び、ケーシング19内の各電極板11, 12が、左右方向すなわちワークWの移動方向と直交する方向に並設されている。

【0091】

一方、第3実施形態では、上記第1実施形態とは異なり、電極板11, 12が、その並設方向すなわち左右方向に対し角度 θ （ $\theta < (\pi/2)$ ）になるように傾けられている。ワークWの移動方向（前後方向）に対しては角度 $((\pi/2) - \theta)$ だけ傾けられている。したがって、電極間スリット10aの延び方向も、ワークWの移動方向に対し角度 $((\pi/2) - \theta)$ だけ傾けられている。なお、第3実施形態では、電極板11, 12及び電極間スリット10aが、前方（図16において上）に向かって右に傾いているが、左に傾いていてもよい。

【0092】

図16の一点鎖線L1に示すように、1の電極間スリット10aの前端部（図16において上端）と、その直ぐ右隣の電極間スリット10aの後端部（図16において下端）とは、ワークWの移動方向すなわち前後方向に沿う同一直線上に位置している。換言すると、1の電極間スリット10aの前端部の左右方向の位置と、その隣の電極間スリット10aの後端部の左右方向の位置が、互いに揃えられている。したがって、第3実施形態のプラズマ処理装置M1では、スリットアレイ100が、次式の関係を満たしている。

$$L \times \cos \theta = (t + d) \times \csc \theta \quad \dots (式1)$$

ここで、Lは、電極間スリット10aの長さであり、tは、各電極板11, 12の厚さ（隣り合う電極間スリット10aどうし間の間隔）であり、dは、電極間スリット10aの幅（隣接する電極板11, 12間の間隔）である。

【0093】

なお、図示は省略するが、電極モジュール10の上側に設けられる整流モジュール20のスリット状整流板23a(図2参照)も、前記電極間スリット10aに合わせて斜めになっており、対応する電極間スリット10aの上端開口の全長にわたってストレートに連なっている。

【0094】

上記構成において、各電極間スリット10aでプラズマ化された処理ガスが、ワークWに吹付けられる。同時に、移動機構4によってワークWが前後に移動される。この時、ワークWの各ポイントは、電極間スリット10aの真下と、電極板11, 12の真下を斜めに横断する。これによって、プラズマガスの曝露量を平均化することができる。しかも、隣接する電極間スリット10aの前後逆側の端部どうしが同一の前後方向直線上に位置しているので、ワークWをひと通り通すと、ワークW上のすべてのポイントにおいてプラズマガス曝露量を等量にすることができる。これによって、ワークWの全体にわたって表面処理を確実に均一に行なうことができ、縞状のムラが出来るのを確実に防止することができる。特に、略常圧環境ではガスが拡散しにくくムラが出来やすいところ、これを効果的に防止することができる。

各電極板11, 12は、上記第1実施形態と同様に、ワークWの大きさに拘わらず短小にでき、湾曲を確実に防止できる。

【0095】

前後逆側の端部どうしが同一の前後方向直線L1上に揃えられるべき2つの電極間スリット10a, 10aは、直ぐ隣のもののどうしに限られず、1つ置き又は複数個置きに隣り合うもののどうしであってもよい(複数個隣のもののどうしであってもよい)。すなわち、スリットアレイ100が、上記式1を一般化した次式を満たしていればよい。

$$L \times \cos \theta = n \times (t + d) \times \csc \theta \quad \dots (\text{式} 2)$$

ここで、nは、1以上の整数である。図16(1つ隣のもののどうしの場合)においては、n=1である。

【0096】

図17は、上記式2においてn=2の場合を満たした電極モジュール10を示したものである。この電極モジュール10では、各電極板11, 12ひいては電極間スリット10aが、図16のものより大きく傾けられている。そして、1の電極間スリット10aの前端部と、それと1つ置きに隣り合う(すなわち2つ隣の)電極間スリット10aの後端部とが、同一の前後方向直線L1上に揃えられている。

【0097】

図18に示すように、各電極板11, 12が、並設方向に対し直交し、電極モジュール10それ自体の構造が図1のものと同様になっていても、全体を斜めに配置することにより、電極板11, 12ひいては電極間スリット10aを傾けることができる。

【0098】

図18においては、処理ヘッド1の全体が、平面視時計方向に角度 θ' ($=(\pi/2) - \theta$)だけ傾けられている。これによって、電極モジュール10の長手方向が、左右方向に対し角度 θ' だけ傾けられている。また、電極板11, 12ひいては電極間スリット10aが、前後方向すなわちワークWの移動方向に対し角度 θ' だけ傾けられている。そして、1の電極間スリット10aの前端部が、直ぐ右隣の電極間スリット10aの後端部と、同一の前後方向直線L1上に位置されている。図18の電極モジュール10では、上記式2と等価の次式の関係が満たされている。

$$L \times \cos(\pi/2 - \theta') = n \times (t + d) \times \sin(\pi/2 - \theta') \quad \dots (\text{式} 3)$$

式3のL、t、d、nは、上記式2の定義と同様である。図18の電極モジュール10の場合、n=1である。勿論、nが2以上の整数になるように傾けることにしてもよい。平面視時計方向ではなく、反時計方向に傾けることにしてもよい。

【0099】

図16～図18のような斜設構造においても、スリットアレイ100を前後に複数段設

けることにしてもよい。

例えば、図19に示す処理ヘッド1は、前後に配置された2つの電極モジュール10を有し、前後2段のスリットアレイ100を有している。各電極モジュール10のケーシング19は、図16のものと同様に、ワーク移動方向と直交する左右方向に延びており、その内部に電極板11, 12が左右に並設されて収容されている。これら電極板11, 12ひいては電極間スリット10aが、左右並設方向に対し所定角度 θ になるように傾けられている。前後の電極モジュール10の電極間スリット10aどうしは、半ピッチだけ左右にずれている。図示は省略するが、各電極モジュール10の上側には、ガス整流モジュール20がそれぞれ設置されている。

なお、図19においては、傾き角度 θ が、上記式1（すなわち式2の $n=1$ の場合）を満たす大きさになっているが、式2の $n \geq 2$ を満たす大きさになっていてもよい。

かかる2段斜設構造によれば、より一層均一な表面処理を行なうことができる。また、各電極板11, 12の一層の短小化を図ることができる。

【0100】

図20は、図18の斜設電極モジュール10を複数段構造にした実施形態を示したものである。この実施形態の処理ヘッド1は、図18と同様の斜設電極モジュール10を前後に2つ備えている。各電極モジュール10の長手方向は、左右方向に対し角度 θ' をなす方向に延びている。電極板11, 12ひいては電極間スリット10aは、電極モジュール10の長手方向に互いに並設されるとともに、電極モジュール10の長手方向と直交する方向、すなわちワークWの移動方向に対し角度 θ' をなす方向に向けられている。

前後の電極モジュール10は、互いに左右に少しずれているが、ずれていなくてもよい。

【0101】

図21は、上記第2実施形態（図5～図14）の装置を斜設構造にした実施形態を示したものである。この実施形態の処理ヘッド1は、前後2段をなして横に並設された多数の電極モジュール10を備えている。これにより、前後2段のスリットアレイ100が構成されている。そして、処理ヘッド1の全体が、平面視時計方向に角度 θ' だけ傾けられている。これによって、電極モジュール10の並設方向が、左右方向（ワークWの移動方向と直交する方向）に対し角度 θ' をなすように傾けられている。電極モジュール10の各電極板11, 12ひいてはスリットアレイ100の各スリット10aは、並設方向に対し直交しており、したがって、前後方向すなわちワークWの移動方向に対し角度 θ' をなす方向に傾いている。この傾き角度 θ' は、既述の式2、式3と等価の次式が満たされるように設定されている。

$$\theta' = \tan^{-1} (n \times P / L) \quad \dots (式4)$$

ここで、Pは、電極板11, 12及び電極間スリット10aのピッチ（例えば $P=12\text{ mm}$ ）であり、Lは、電極間スリット10aの長さ（例えば $L=300\text{ mm}$ ）であり、nは、1以上の整数である。図21の装置では、 $n=1$ である。これによって、左右に隣合う2つの電極スリット10aにおいて、左側の電極スリット10aの前端部と、右側の吹出しスリット10bの後端部とが、ワークWの前後移動方向に沿う同一の直線L1上に位置することになる。

なお、電極モジュール10の具体構造は、図6～図13に示す第2実施形態と同様であるが、端電極板12L, 12Rを、第2実施形態のものに代えて図15に示す第2実施形態の変形態様と同様に構成してもよい。前側の段と後側の段は、半ピッチ（ $P/2$ ）だけ左右にずれているが、必ずしもずれている必要はない。

【0102】

ここまでの実施形態では、処理ヘッド1が架台に固定されており、動くことがなかったが、処理ヘッド1をワークWの移動方向に対し交差する方向に相對揺動させることにしてもよい。

すなわち、図22に示す第4実施形態では、左右に並設された1段のモジュールユニット1Xからなる処理ヘッド1が、架台（図示せず）に左右スライド可能に支持されている

。この処理ヘッド1に揺動機構8が接続されている。揺動機構8は、例えば往復アクチュエータや、回転アクチュエータ及びその回転を往復動に変える変換機構等で構成され、処理ヘッド1全体を左右に揺動させるようになっている。プラズマ処理時においては、移動機構4にてワークWを前後に移動させるとともに、揺動機構8にて処理ヘッド1を左右（すなわちワークWの移動方向と直交する方向）に揺動させながら、処理ガスをプラズマ化し、ワークWに吹付ける。これによって、各スリット10aの延び方向とワークWの移動方向が平行になっていても、縞状の処理ムラが形成されるのを防止でき、表面処理の均一性を向上させることができる。

【0103】

揺動機構8による揺動振幅は、例えば電極板11, 12及び電極間スリット10aのピッチPの1/2だが、実際には、位置精度や加減速の関係で、揺動振幅をP/2より大きな範囲で最適化するのが望ましい。これによって、縞状の処理ムラを確実に解消することができる。

【0104】

また、揺動周期は、移動機構4によるワークWの移動速度に応じて最適化する。具体的には、ワークWが、スリット10aの長さ分の距離だけ移動する時間に、処理ヘッド1が、ちょうど自然数回（望ましくは複数回）揺動するような周期に設定する。これによって、揺動自体によるムラの発生を防止することができる。

【0105】

図23は、上記揺動機能付きの第4実施形態の変形態様を示したものである。この態様の処理ヘッド1は、前後2段をなして左右に並設されたモジュールユニット1Xにて構成されている。前側（図23において上側）の段のモジュールユニット1Xの全体が、一体となって左右スライド可能になるようにして、図示しない架台に支持されている。また、後側（図23において下側）の段のモジュールユニット1Xの全体が、一体となって、かつ前側の段とは別個に左右スライド可能になるようにして、上記架台に支持されている。前段モジュールユニット1Xには、第1揺動機構8Aが接続され、後段モジュールユニット1Xには、第1揺動機構8Bが接続されている。これら揺動機構8A, 8Bは、上記揺動機構8と同様の構造をなし、対応する段のモジュールユニット1Xを左右に揺動させるようになっている。しかも、これら揺動機構8A, 8Bは、互いに協働して、揺動の位相を互いにずらすようになっている。この位相差 ϕ は、例えば、 $\phi = \pi/2$ である。揺動の振幅及び周期は、上記揺動機構8と同様である。これによって、処理ムラを確実に防止でき、表面処理の均一性をより向上させることができる。

【0106】

本発明は、前記実施形態に限定されず、種々の形態を採用可能である。

例えば、スリットアレイ100は、1段又は2段に限られず、3段以上設けることにしてもよい。この場合も、隣り合う段どうしを、スリット10aの並設方向にずらすのが好ましい。このずれは、ピッチP÷（段の数）とするのが好ましい。特に、各スリット10aの延び方向がワークWの移動方向と平行の場合には、段数を多くすればするほど処理の均一性を高めることができる。なお、均一性があまり要求されない処理（例えば洗浄等）の場合は、各スリット10aの延び方向がワークWの移動方向と平行でも、スリットアレイ100は1段のみで十分である。

【0107】

図16、図17に示す斜設構造の各実施形態では、傾斜角度 θ が、式1の $n=1$ 、 $n=2$ をそれぞれ満たすようになっているが、 $n=3$ 以上を満たすようにしてもよい。図18～図21に示す斜設構造の各実施形態では、傾斜角度 θ' が、式4の $n=1$ を満たすようになっているが、 $n=2$ 以上を満たすようにしてもよい。更に、斜設構造の傾斜角度は、必ずしも式1～式4を満たしていなくてもよい。処理条件などに応じて、0度より大きく90度より小さい範囲で適宜設定できる。

【0108】

図22に示す揺動機能の実施形態において、処理ヘッド1を固定する一方、ワークWを

前後に移動させながら左右に揺動させることにしてもよい。この場合、移動機構に揺動機構を組み込むことにしてもよい。勿論、ワークWを固定する一方、処理ヘッド1を前後に移動させながら左右に揺動させることにしてもよい。

揺動方向は、ワークWの移動方向と交差する方向であればよく、スリット10aの並設方向に沿う方向に限られず、該並設方向に対し斜めをなす方向であってもよい。

図23に示す揺動機能の実施形態では、スリットアレイ100が2段であったが、3段以上設けることにし、段ごとに揺動機構で揺動させ、隣り合う段どうしの揺動位相を互いにずらすようにしてもよい。この位相差 ϕ は、段数をnとすると、例えば $\phi = \pi / n$ であるが、これに限定されるものではなく、処理条件等に応じて適宜設定することができる。3段以上の場合、そのうちの隣り合う2つの段の一方に接続される揺動機構が、特許請求の範囲の「第1揺動機構」となり、他方の段に接続される揺動機構が、「第2揺動機構」となる。一方の段のスリットアレイを固定する一方、第1揺動機構にてワークWを揺動させ、第2揺動機構にて他方の段のスリットアレイを前記ワークWの揺動に対し位相をずらして揺動させるようにしてもよい。

図16～図21のような斜設構造においても、揺動機構によって揺動させるようになっていてもよい。

【0109】

本発明は、処理ガスをスリットから吹出して被処理物に当てるものであればよく、プラズマ表面処理に限られず、熱CVDのような電極の無い表面処理にも適用できる。また、成膜(CVD)、洗浄、エッチング、表面改質、アッシング等の種々の表面処理に遍く適用できる。

処理の圧力条件は、略常圧に限らず、減圧環境でもよい。

【実施例1】

【0110】

実施例を説明する。本発明が以下の実施例に限定されないことは言うまでもない。第2実施形態(図5～図14)と同様のエッチング用のプラズマ処理装置を用い、以下の条件下でエッチング処理を行なった。

電極温度: 50℃

ワーク温度: 100℃

処理ガス

CF₄ 200 sccm

O₂ 800 sccm

H₂O 15 sccm

パルス周波数: 20 kHz

印加電圧 300V

【0111】

そして、前段のスリットアレイからのプラズマガスだけによる処理後の残膜の厚さと、前段と後段の2段階で処理した後の残膜の厚さを、ワークの左右幅方向にわたって測定した。

結果を図24に示す。前段だけによる処理では、膜厚が若干不均一になった。更に後段による処理を経ると、膜厚を、ほぼ均一化できた。

【図面の簡単な説明】

【0112】

【図1】本発明の第1実施形態を示し、図2のI-I線に沿う常圧プラズマ処理装置の平面断面図である。

【図2】図1のII-II線に沿う、前記常圧プラズマ処理装置の正面断面解説図である。

【図3】各電極間スリットからのプラズマガスによる処理能力を示す解説図である。

【図4】ワーキングディスタンスと処理レートの一般的な関係を示すグラフである。

【図5】本発明の第2実施形態を示し、常圧プラズマ処理装置の概略構成の平面図で

ある。

【図 6】図 5 の装置の各電極モジュールの平面図である。

【図 7】図 8 の VII-VII 線に沿う、図 5 装置のモジュールユニットの側面断面図である。

【図 8】図 7 の VIII-VIII 線に沿う、モジュールユニットの正面断面図である。

【図 9】図 8 の IX-IX 線に沿う、前後の段の電極モジュールの平面断面図である。

【図 10】上記電極モジュールの電極板と詰めブロックの接合部の詳細を示す平面断面図である。

【図 11】(a) は、左右に隣り合う電極モジュールを分離して示す正面断面図であり、(b) は、両電極モジュールを連結状態で示す正面断面図である。

【図 12】図 9 の XII-XII 線に沿う、モジュールユニットの正面断面図である。

【図 13】図 8 の XIII-XIII 線に沿う、モジュールユニットの整流モジュールの平面断面図である。

【図 14】前段の電極モジュールと後段の電極モジュールによる処理能力を、ワーク上の位置と処理レートで示したグラフである。

【図 15】上記第 2 実施形態の変形態様を示し、(a) は、左右に隣り合う電極モジュールを分離して示す正面断面図であり、(b) は、両電極モジュールを連結状態で示す正面断面図である。

【図 16】本発明の第 3 実施形態を示し、常圧プラズマ処理装置の平面断面図である。

【図 17】上記第 3 実施形態の変形態様を示す平面断面図である。

【図 18】上記第 3 実施形態の他の変形態様を示す平面断面図である。

【図 19】上記第 3 実施形態の他の変形態様を示す平面断面図である。

【図 20】上記第 3 実施形態の他の変形態様を示す平面断面図である。

【図 21】上記第 2 実施形態の装置に第 3 実施形態の要旨構成を組み合わせた実施形態を示す平面図である。

【図 22】本発明の第 4 実施形態を示す平面図である。

【図 23】上記第 4 実施形態の変形態様を示す平面図である。

【図 24】実施例 1 の結果を示すグラフである。

【符号の説明】

【0113】

M 常圧プラズマ処理装置（表面処理装置）

W ワーク（被処理物）

1 プラズマ処理ヘッド（処理部）

1 X モジュールユニット

1 0 電極モジュール

1 0 a 電極間スリット

1 0 0 スリットアレイ

1 1 ホット電極の電極板

1 2 アース電極の電極板

1 2 L, 1 2 R 端電極板

1 2 X 合体電極板

2 0 整流モジュール

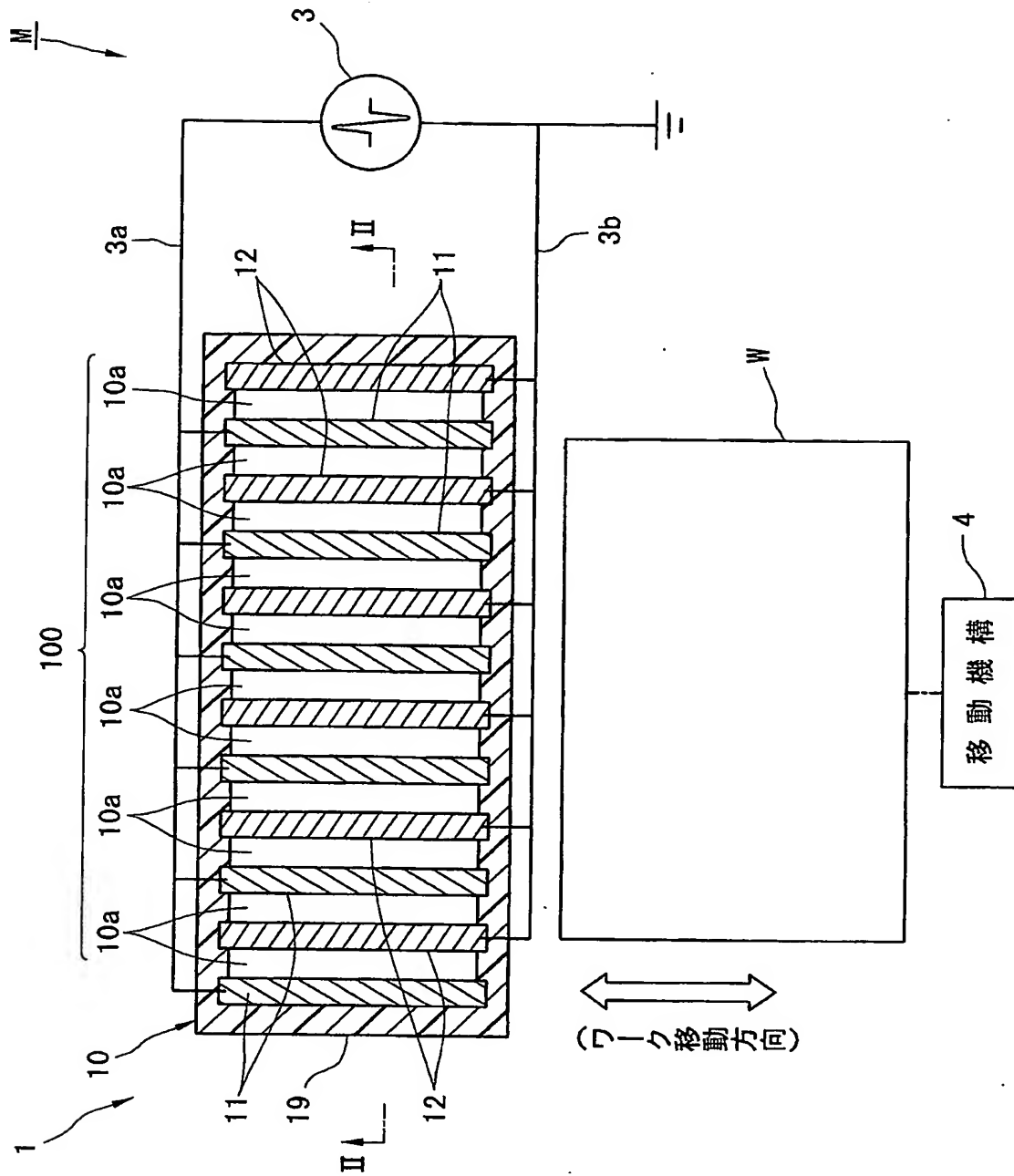
4 移動機構

8 揺動機構

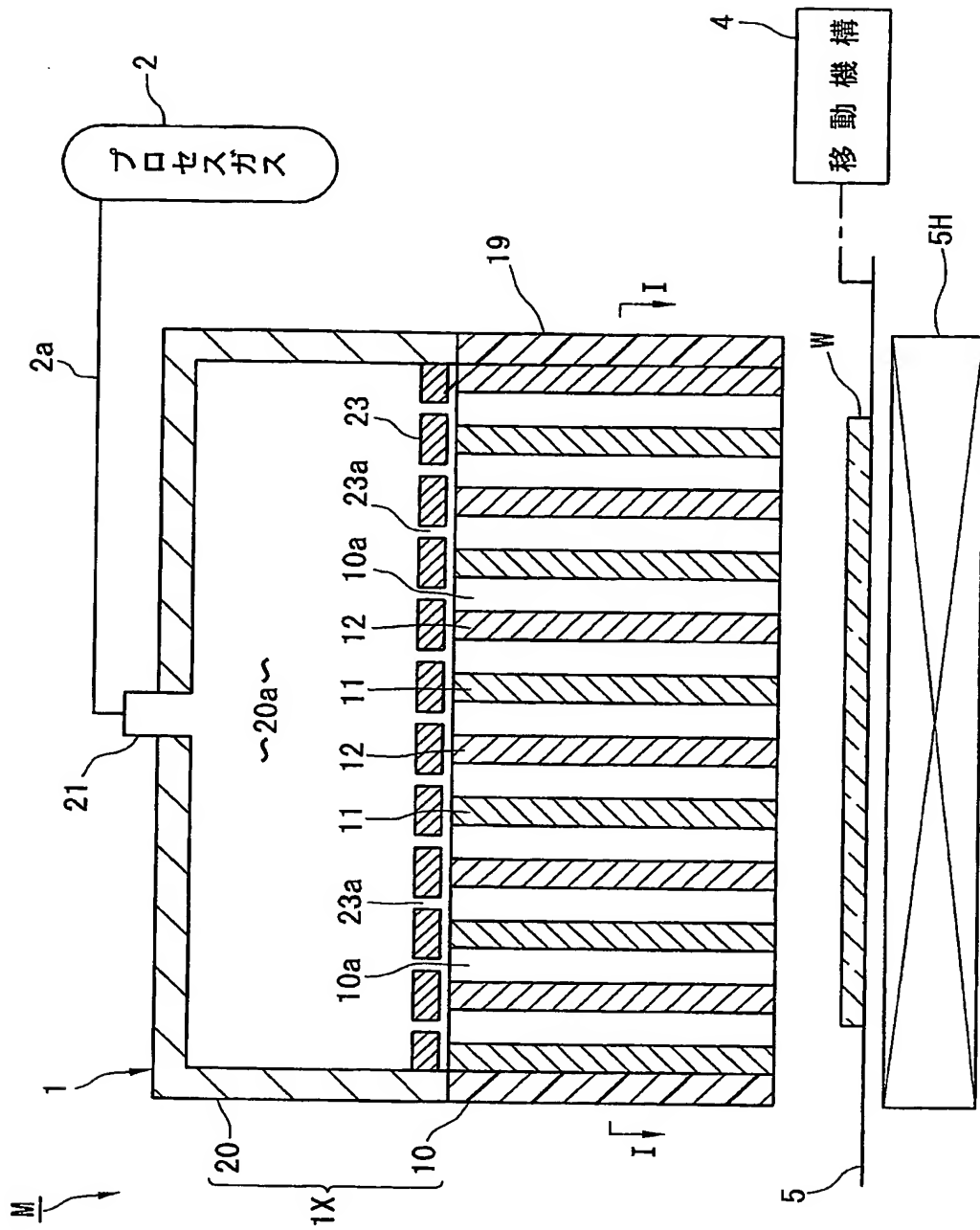
8 A 第 1 揺動機構

8 B 第 2 揺動機構

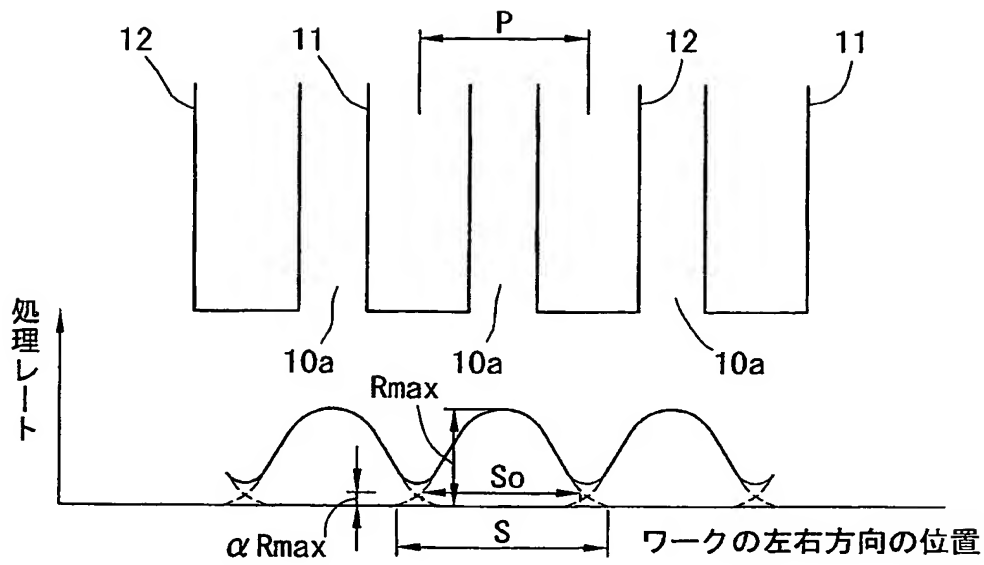
【書類名】図面
【図 1】



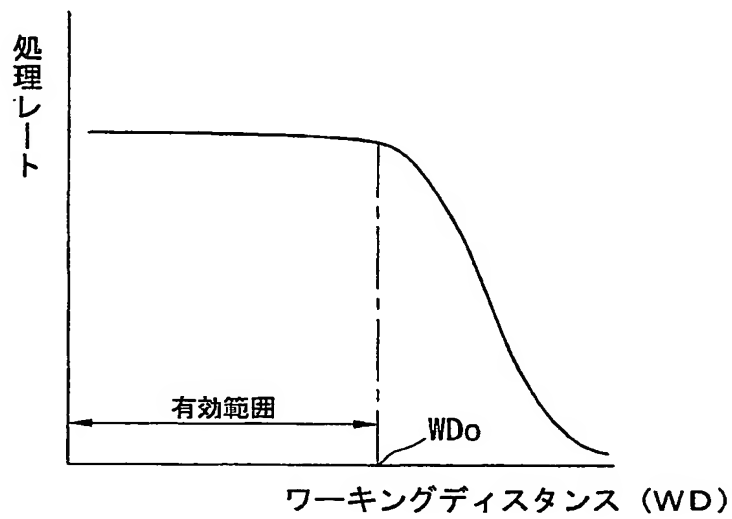
【図 2】



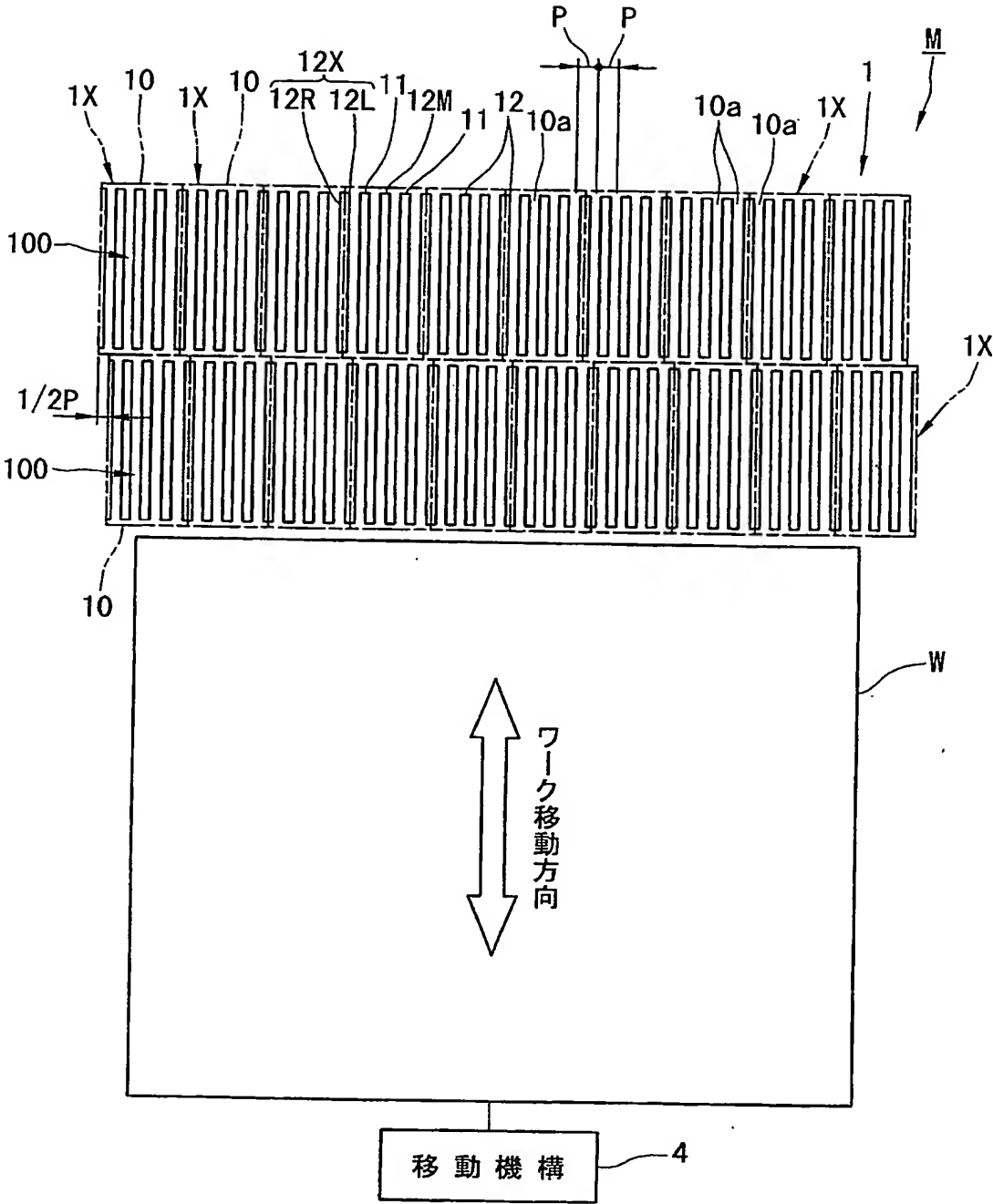
【図 3】



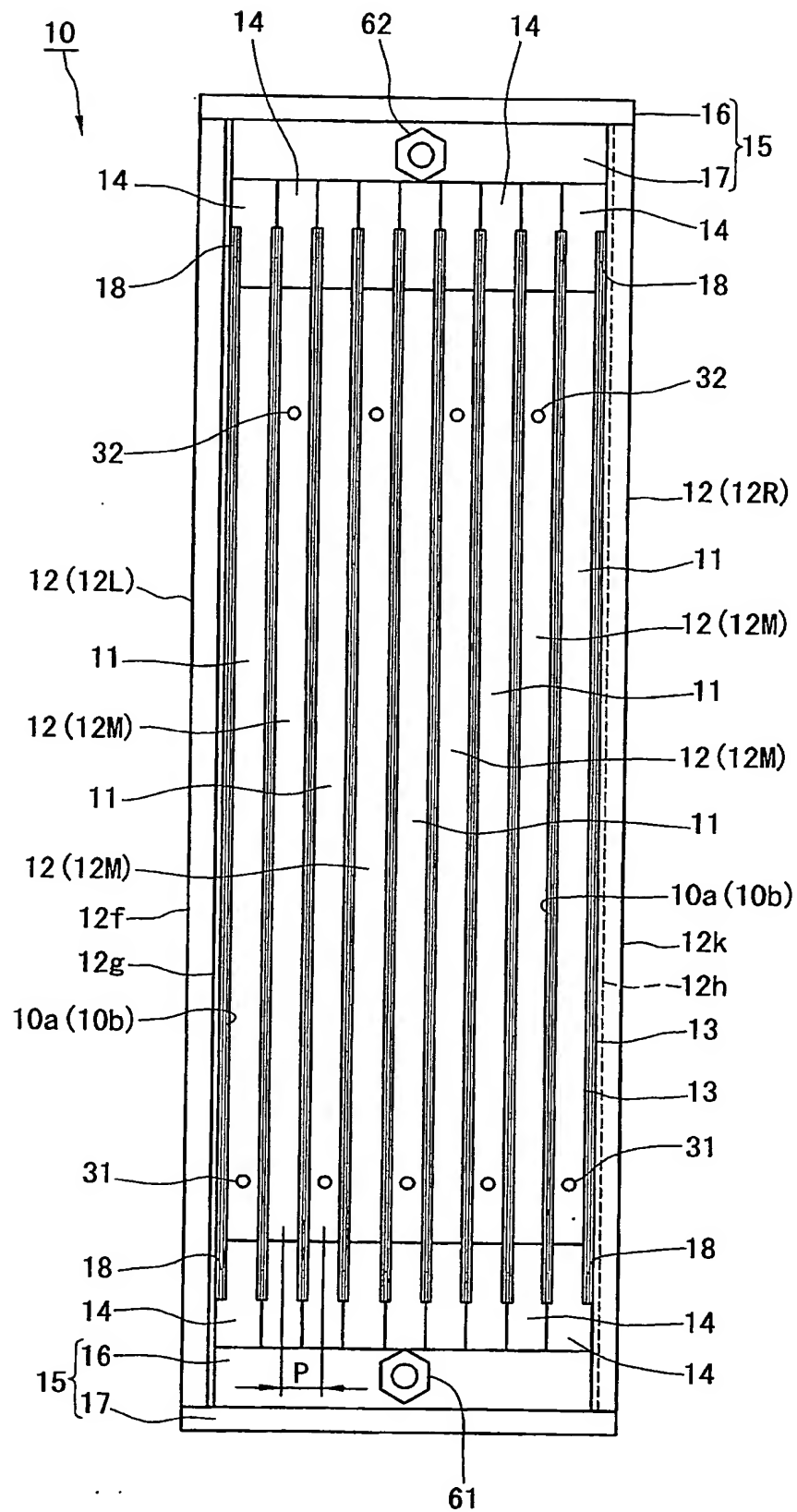
【図 4】



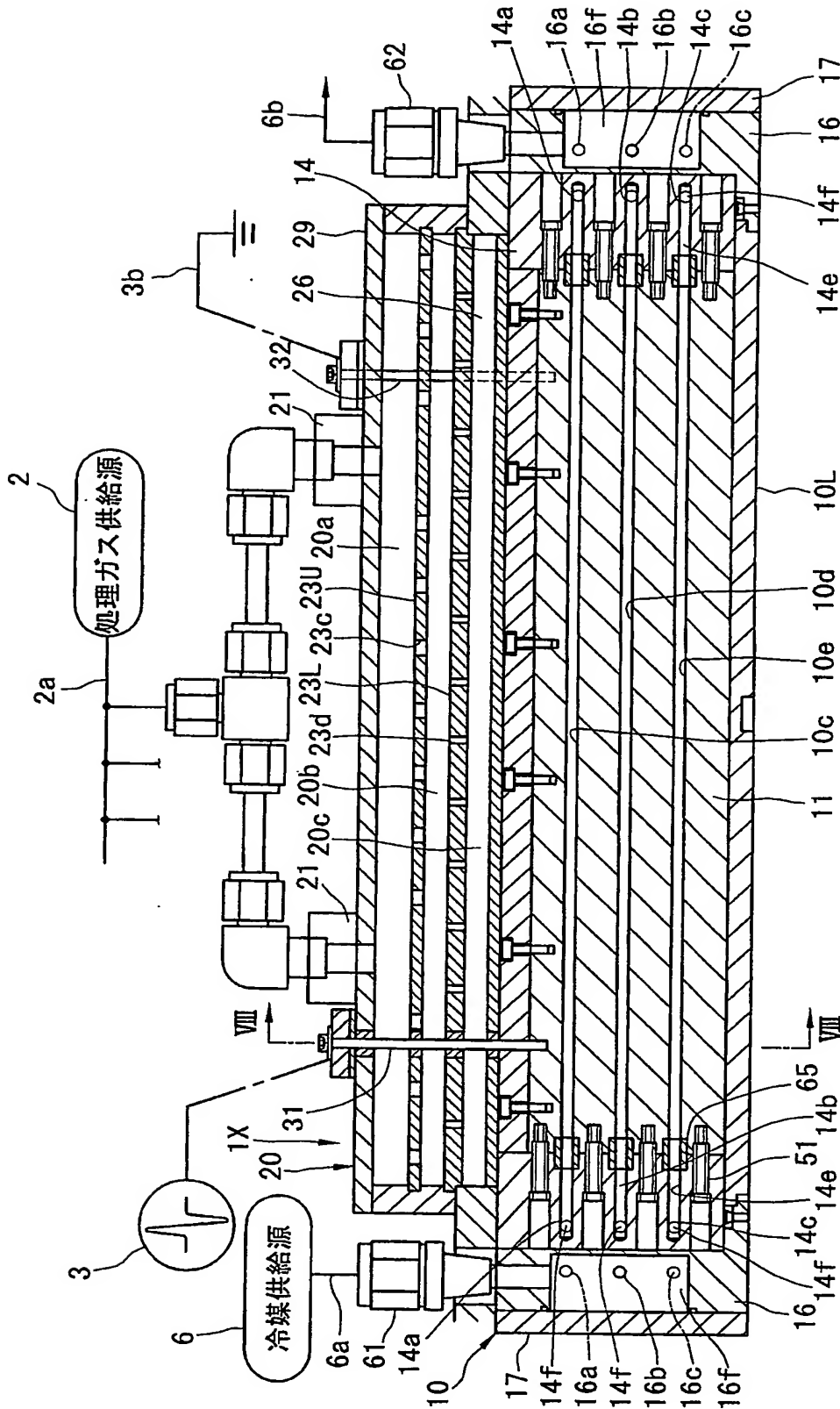
【図 5】

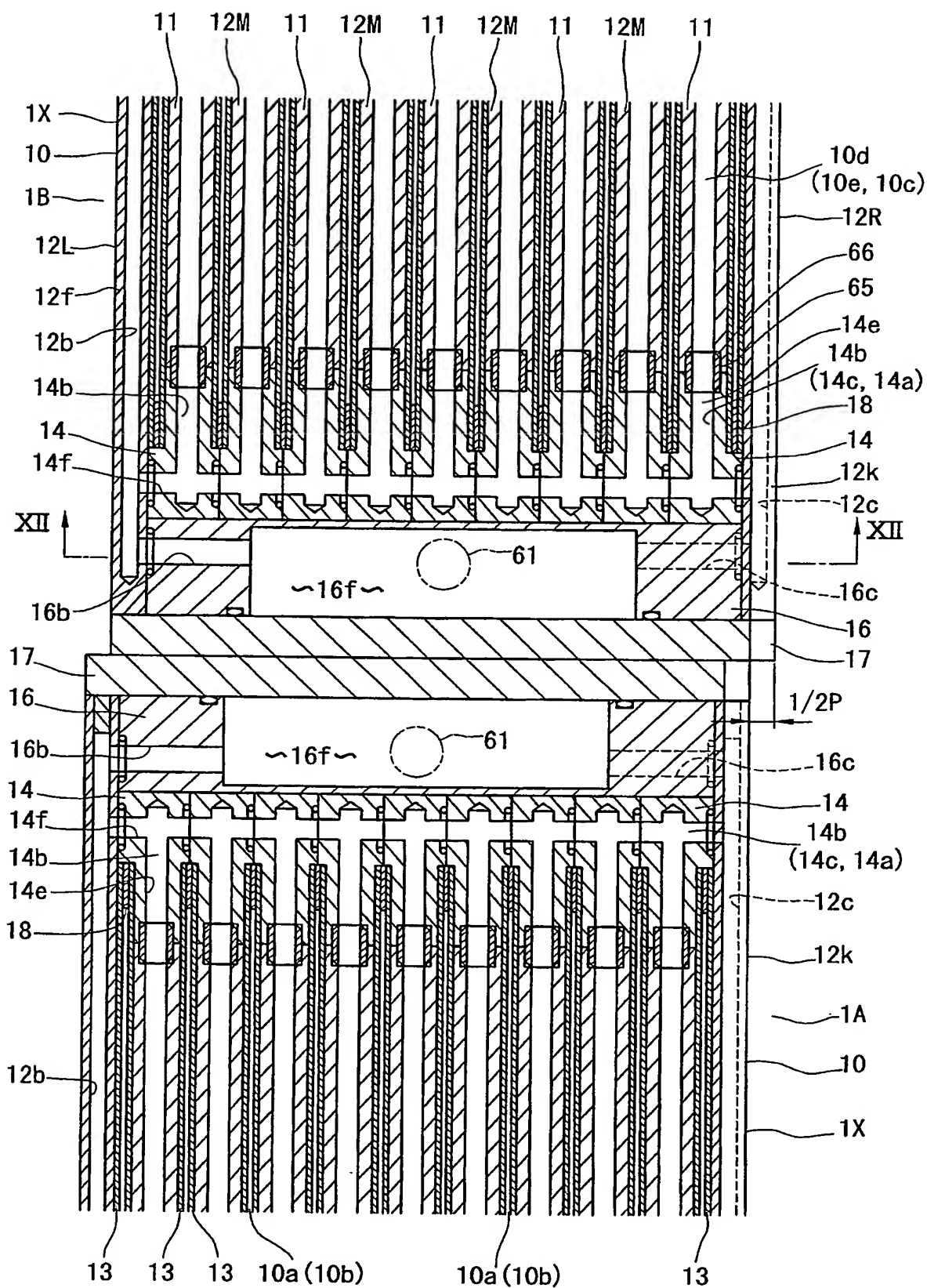


【図 6】

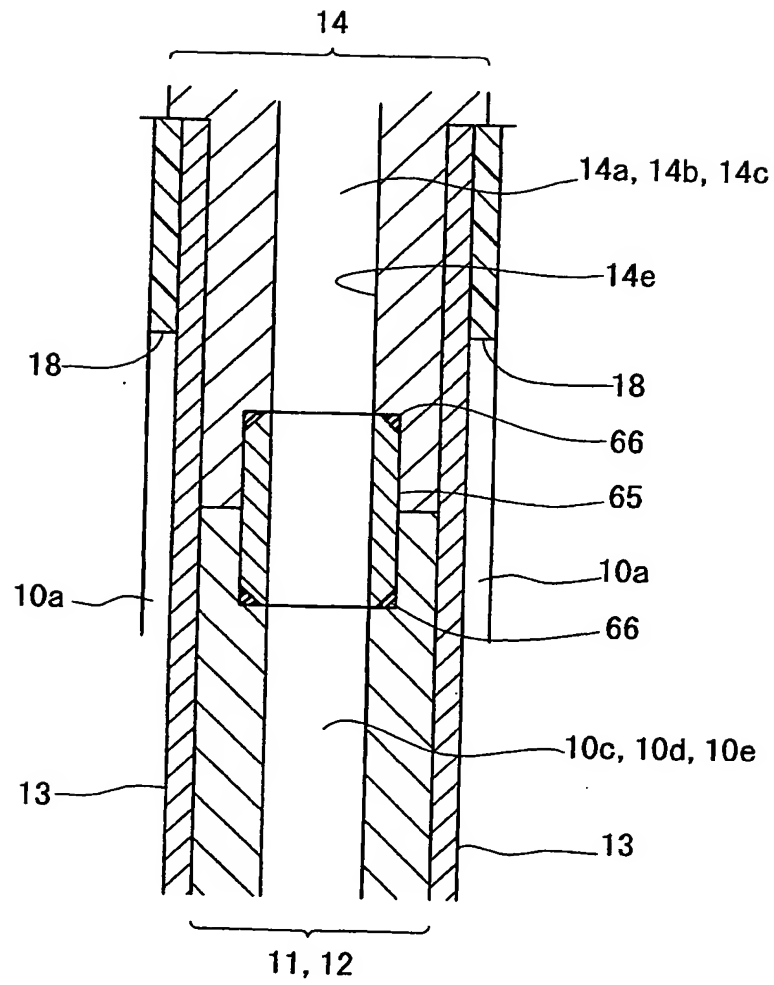


【図 7】



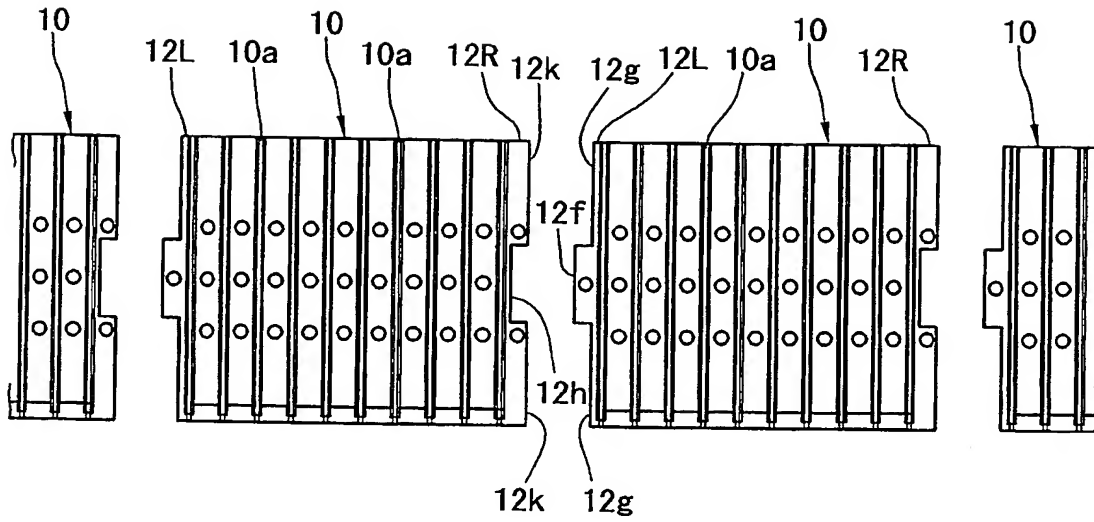


【図 10】

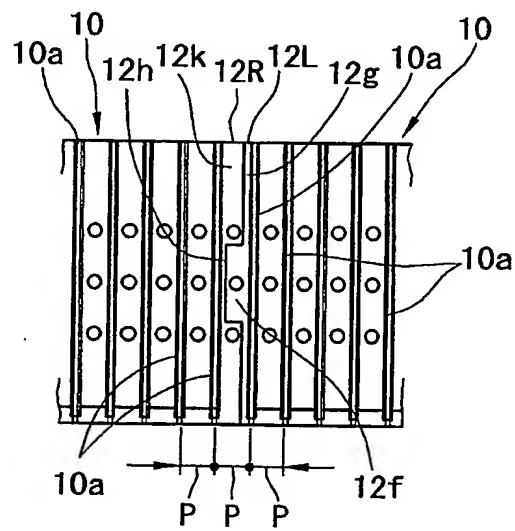


【図 11】

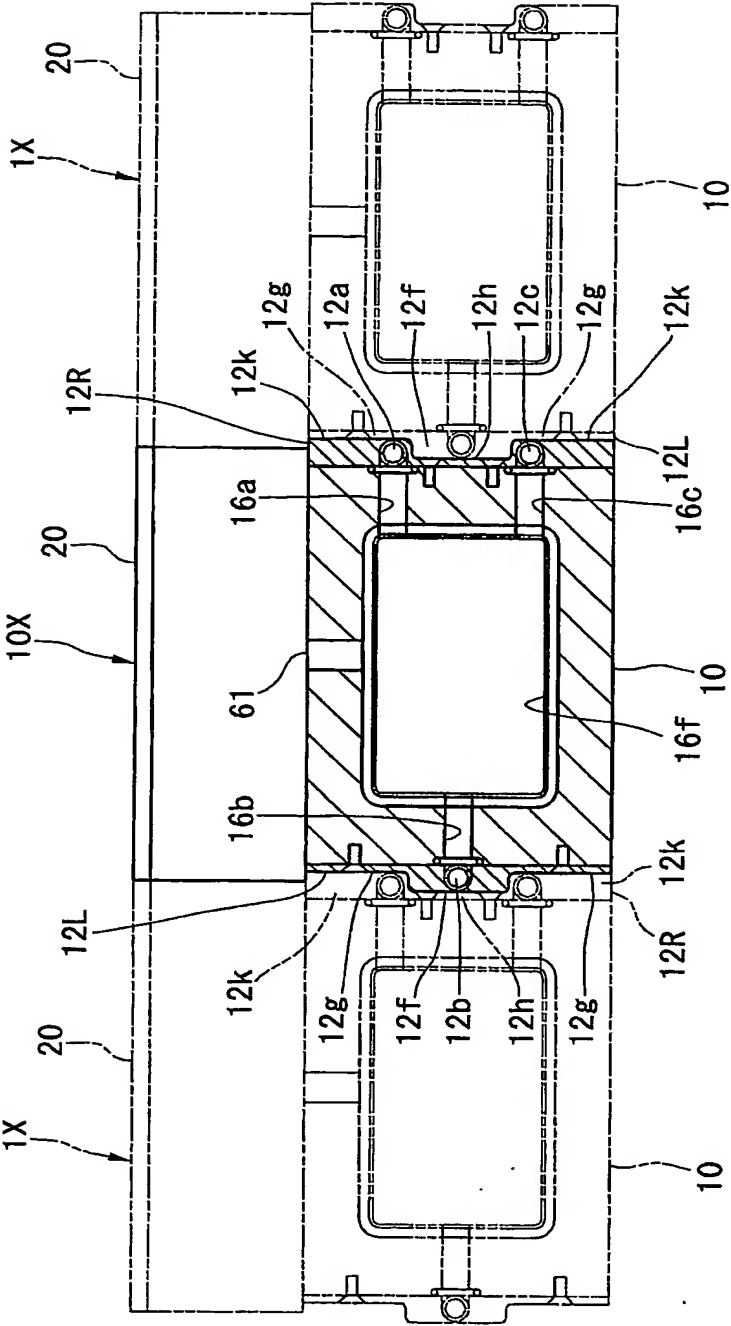
(a)



(b)

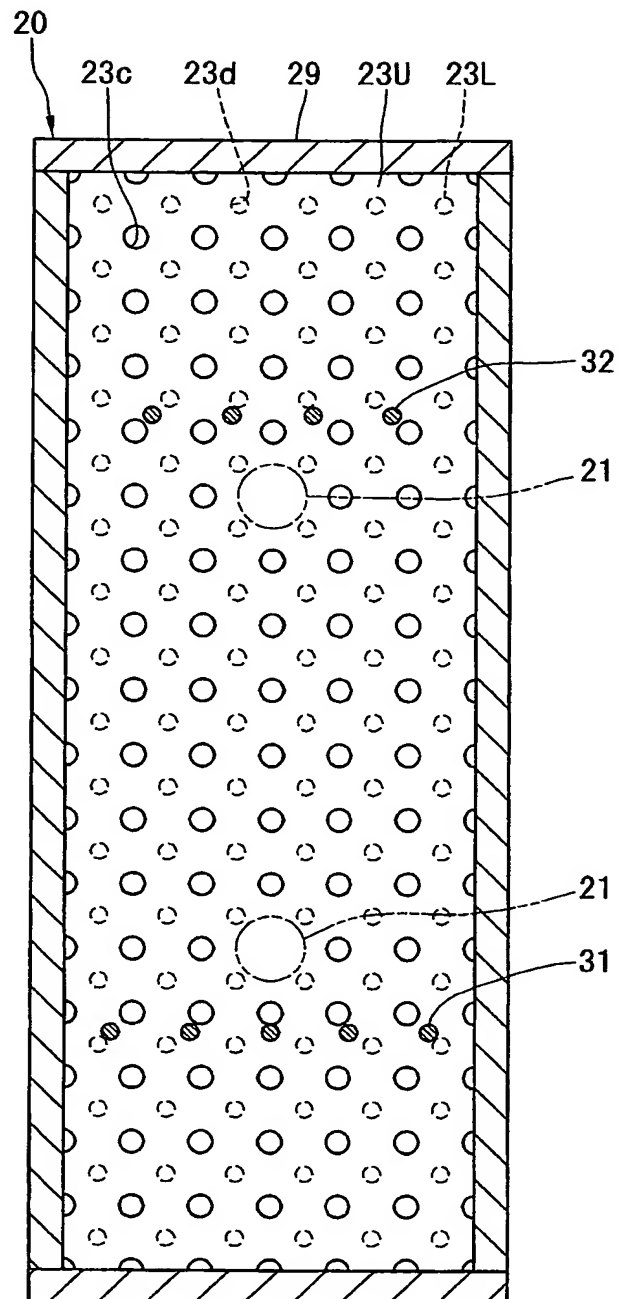


【図 12】

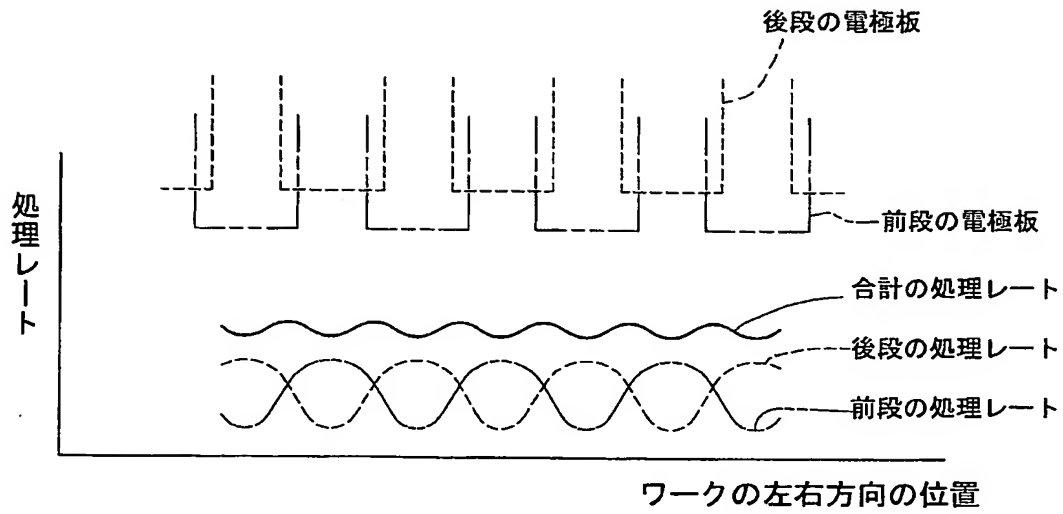




【図 13】

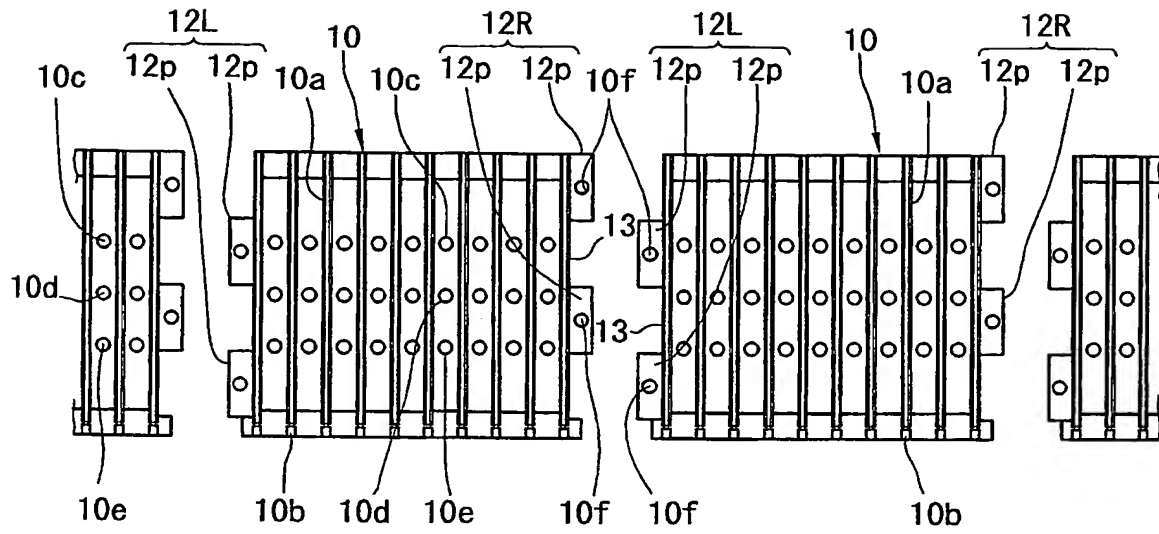


【図 14】

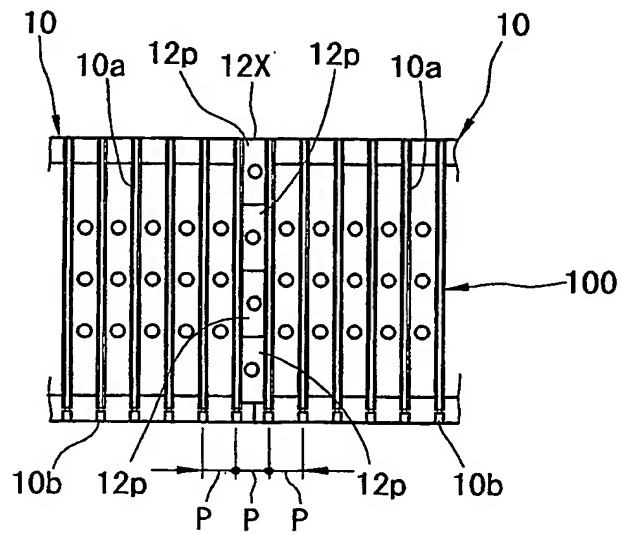


【図 15】

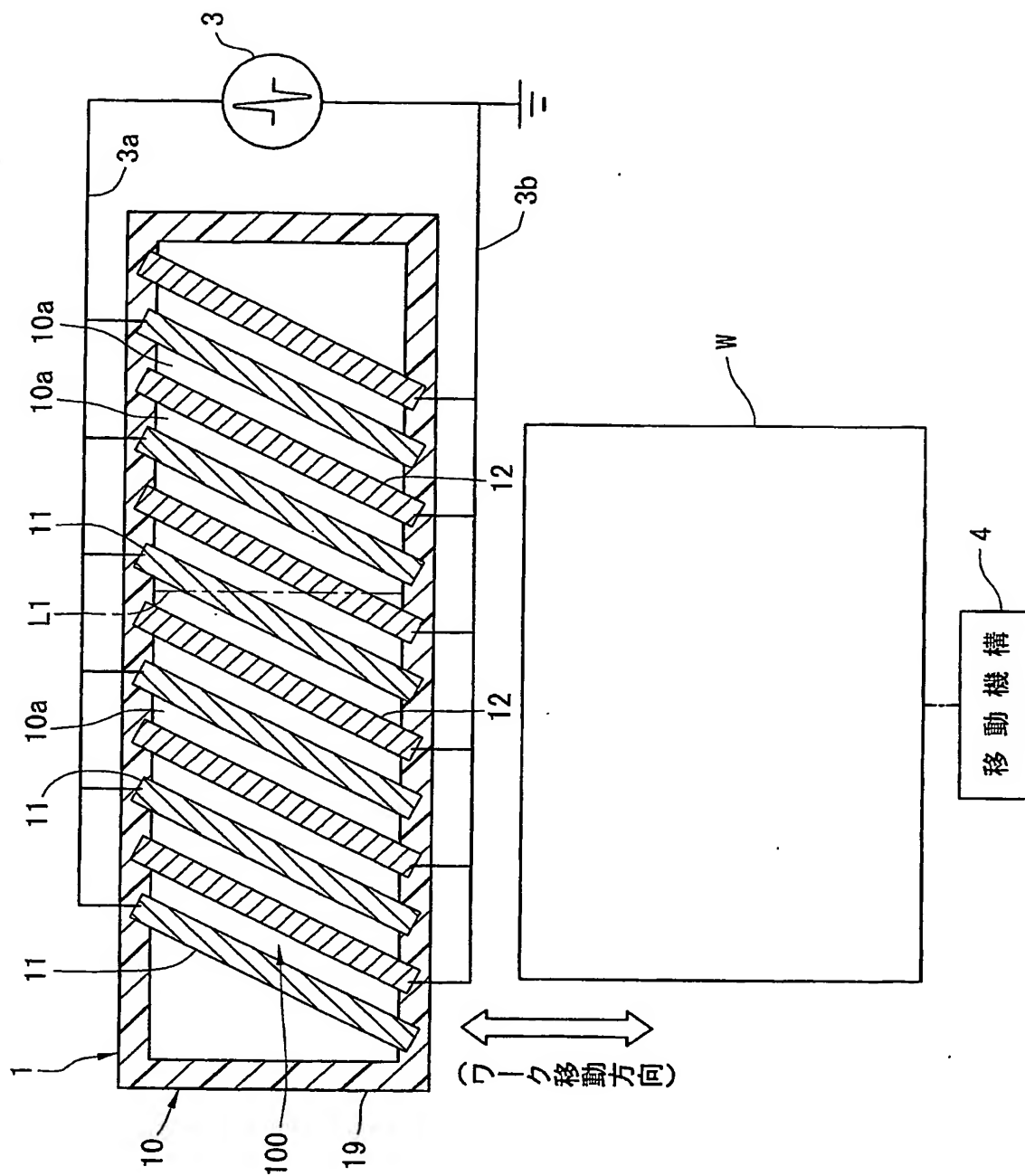
(a)



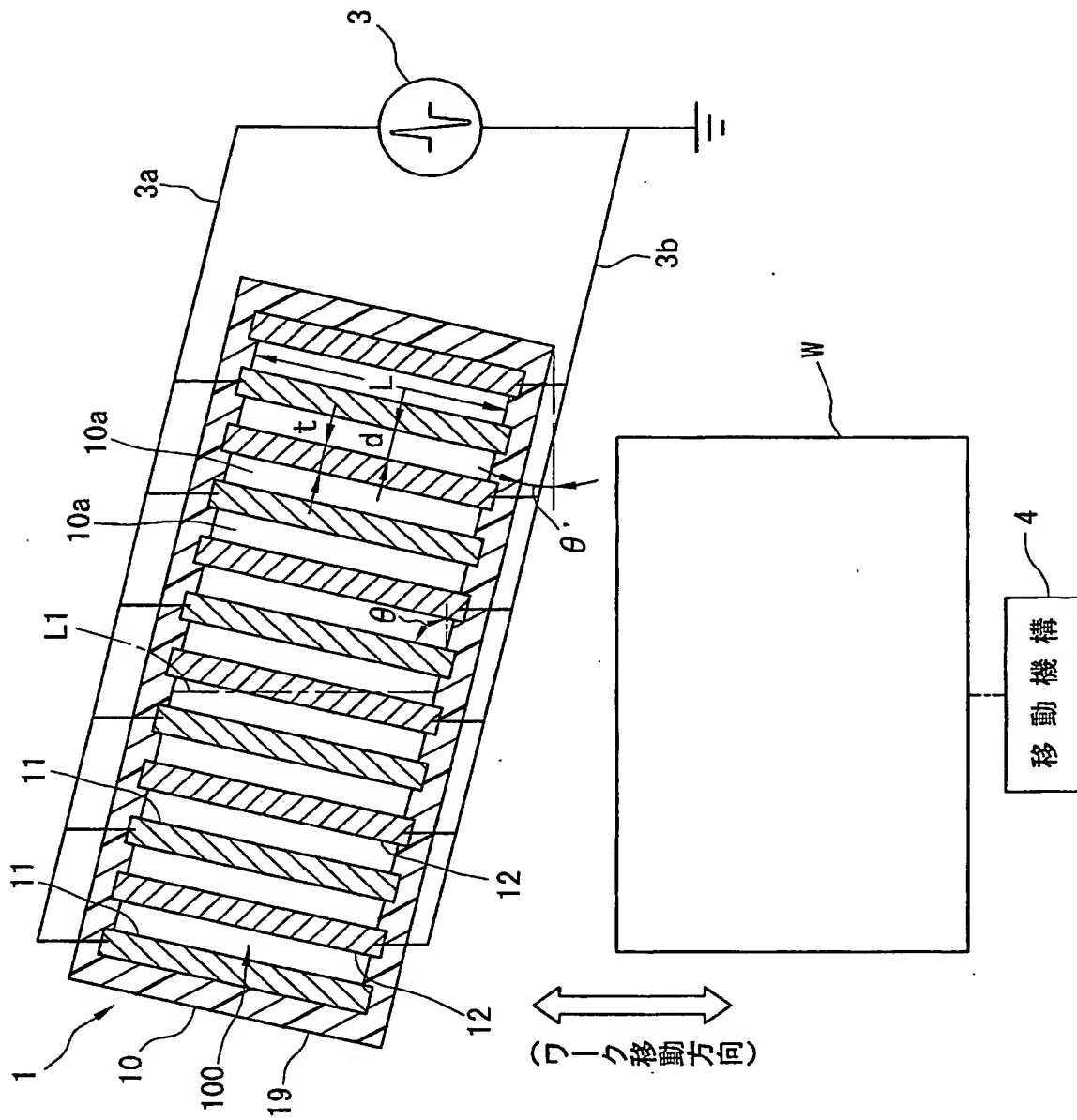
(b)



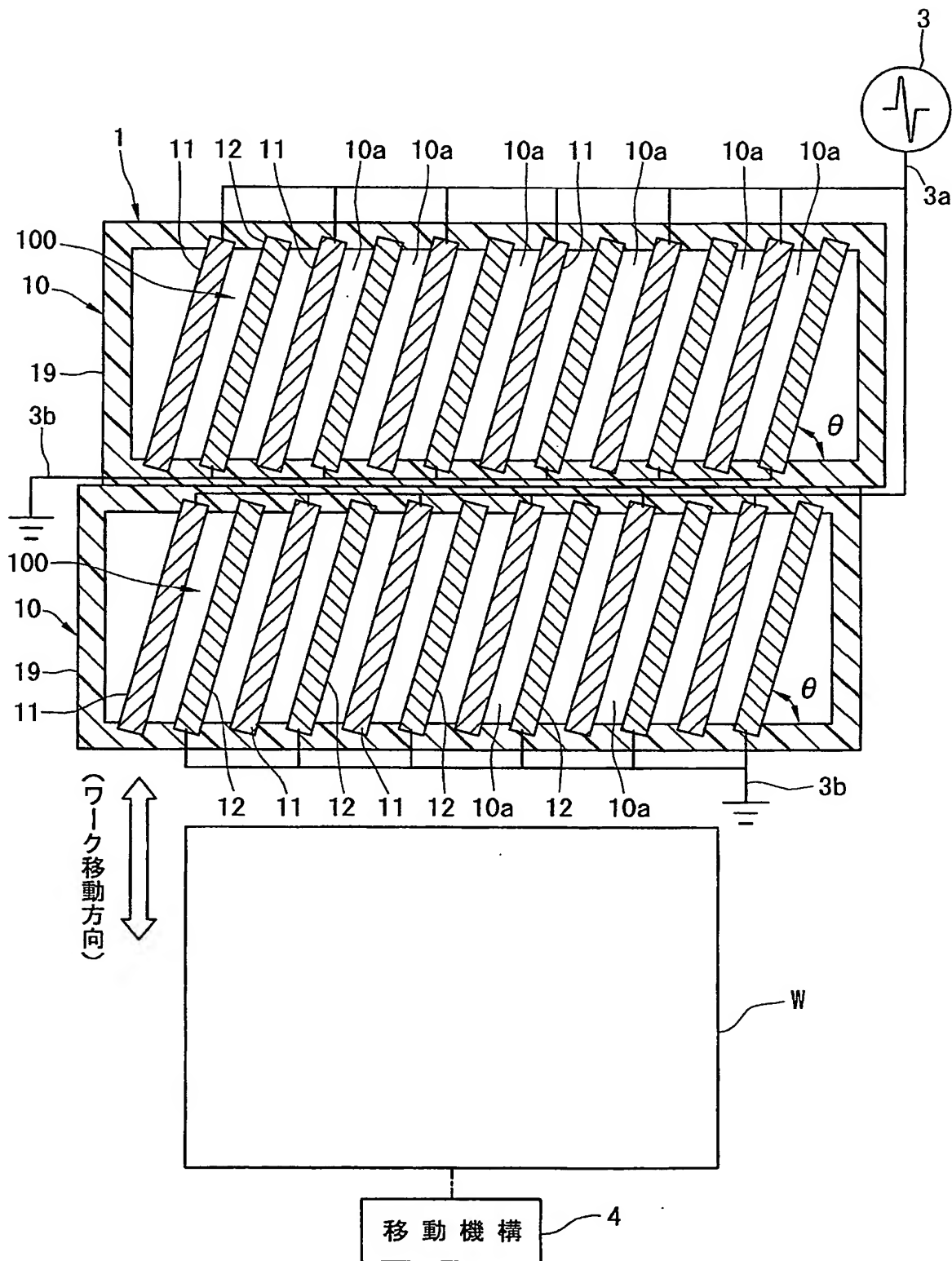
【図 17】



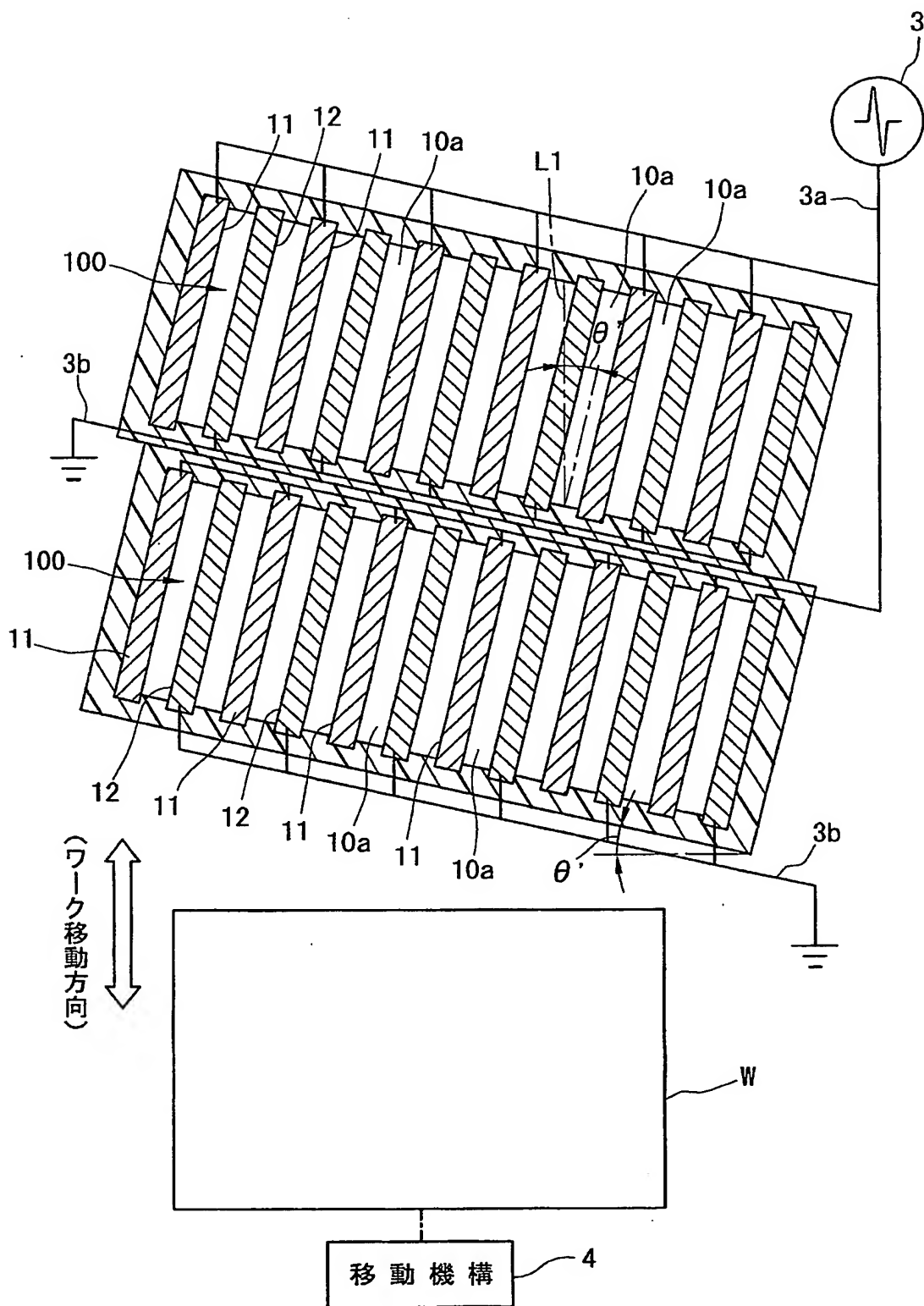
【図 18】



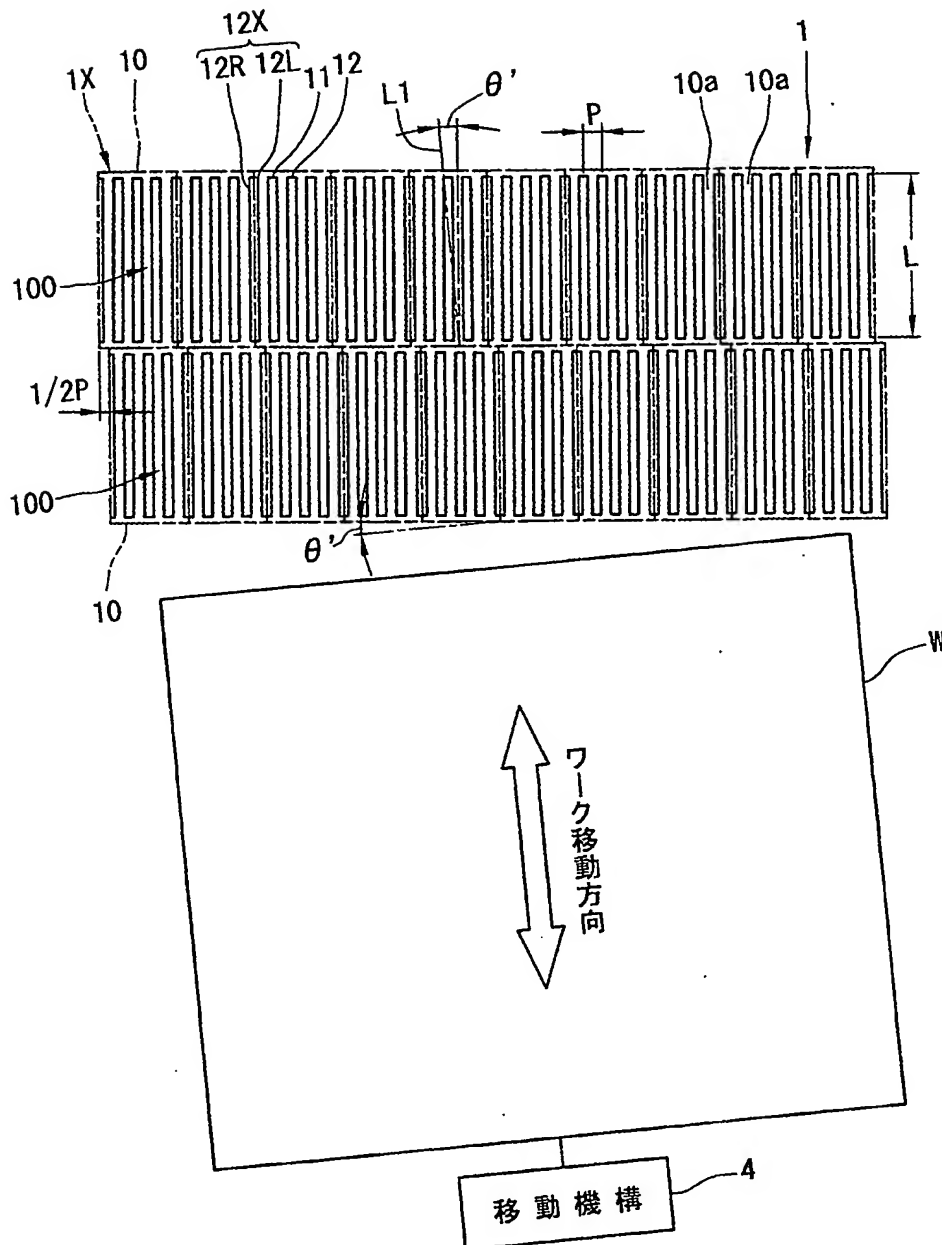
【図 19】



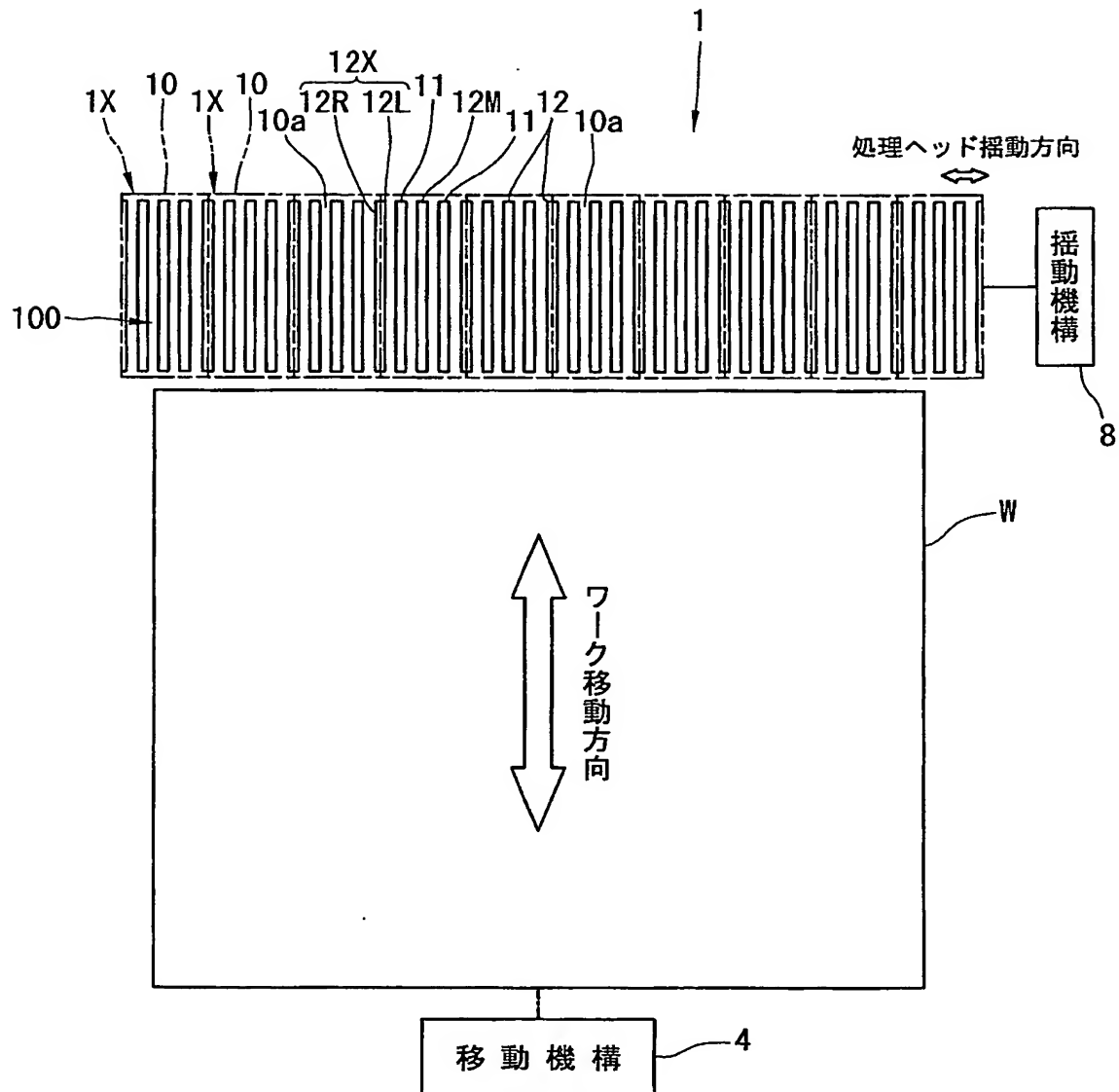
【図 20】



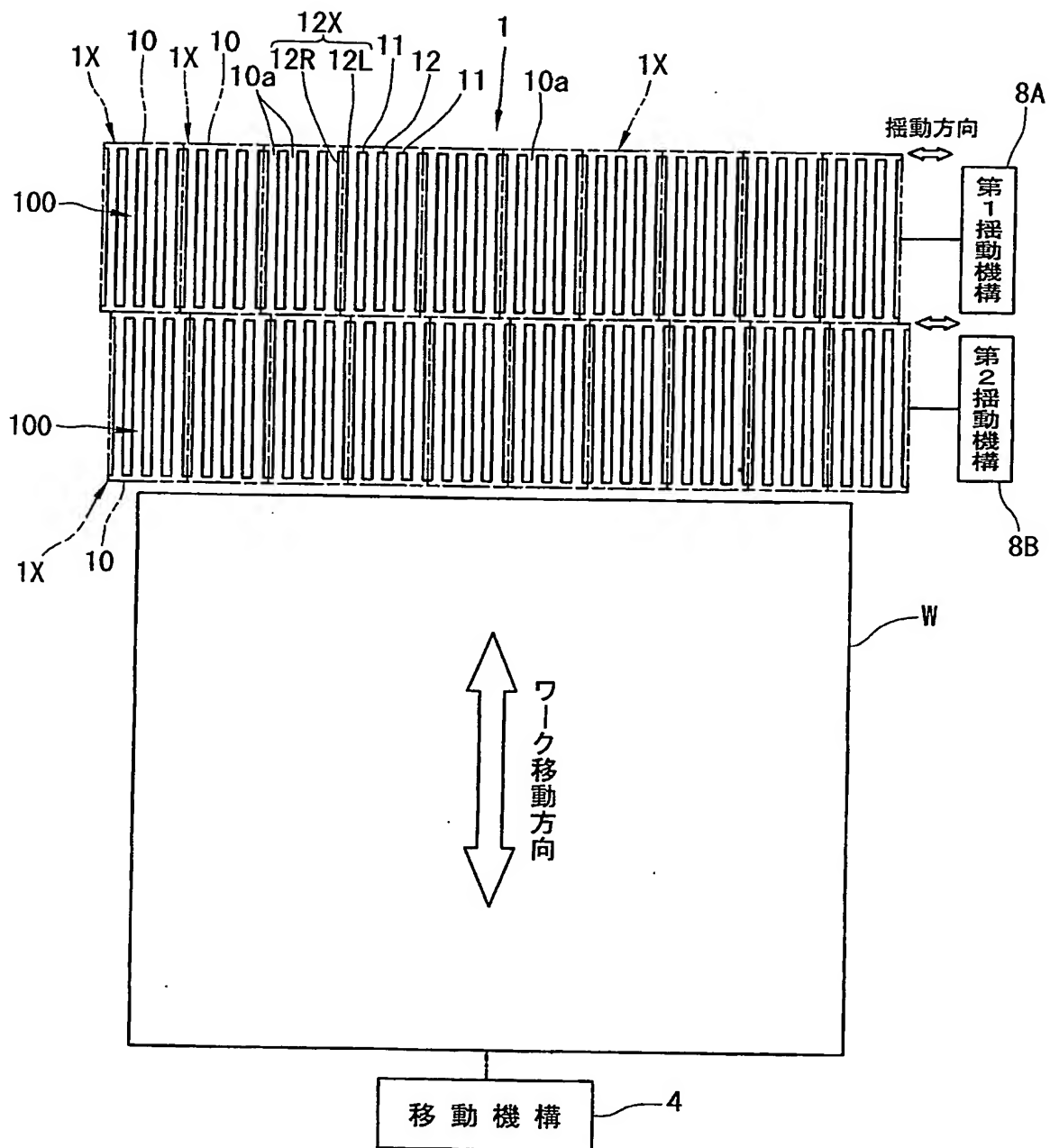
【図 21】



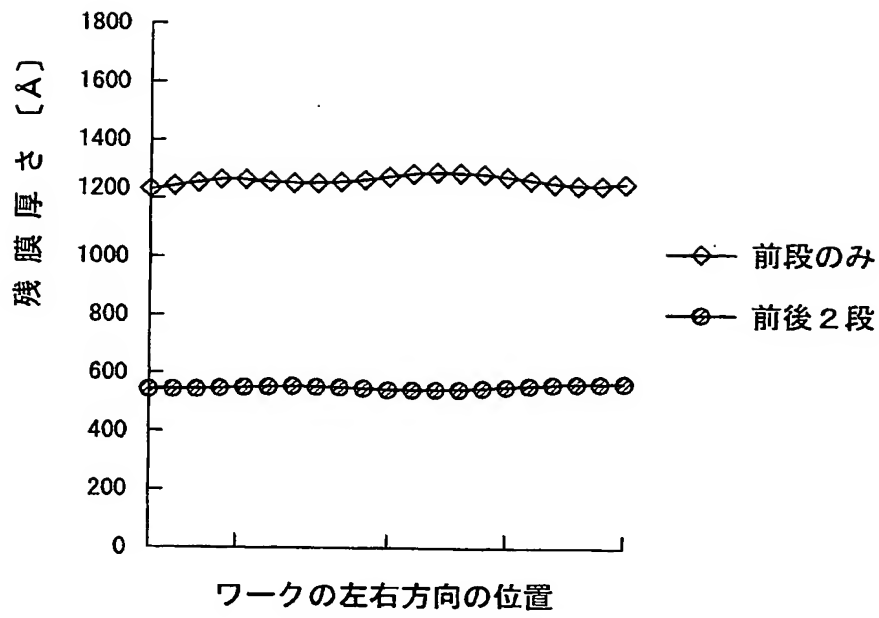
【図 22】



【図 23】



【図 24】



【書類名】 要約書

【要約】

【課題】 処理ガスをスリットから被処理物の表面に吹付ける表面処理装置において、スリットが短くても大面積の被処理物を効率良く表面処理する。

【解決手段】 プラズマ表面処理装置Mの処理部1には、複数の電極板11, 12が並設されている。隣接する電極板どうしの間にスリット10aが形成され、並設された複数のスリット10aにてスリットアレイ100が構成されている。移動機構4によって、被処理物Wを各スリット10aの延び方向に沿って移動させる。

【選択図】 図1

特願 2004-127312

ページ： 1/E

出 願 人 履 歴 情 報

識別番号

[000002174]

1. 変更年月日

1990年 8月29日

[変更理由]

新規登録

住 所

大阪府大阪市北区西天満2丁目4番4号

氏 名

積水化学工業株式会社